

**2026年3月期(2025年4月～2026年3月)
決算説明資料**

2026年5月13日

株式会社 KOKUSAI ELECTRIC

注意事項

本資料及び本資料にて提供される情報は企業情報等の提供のために作成されたものであり、国内外を問わず、当社の発行する株式その他有価証券の勧誘を構成するものではありません。

■ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社グループの事業計画、将来予測などは、当社グループが作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、将来の結果や業績を保証するものではありません。さまざまな外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果は計画、予測と大きく異なる結果となる可能性があります。当社グループは、適用ある法令または証券取引所の規則により要求される場合を除き、本資料に含まれるいかなる情報についても、今後生じる事象に基づき更新または改訂する義務を負うものではありません。なお、当社グループの経営成績、財政状態、キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があるかと認識している主なリスクは、有価証券報告書に記載しております。

■ 為替リスクについて

当社グループにおける海外売上収益は高い水準で推移しております。また、当社グループの外貨建ての資産および負債の評価は為替相場の変動により影響を受けます。当社グループ製品の輸出売上は、ほとんどが円建てで行われておりますが、一部に外貨建売上および費用計上もあり、為替相場の変動により影響を受けることがあります。

■ 経営指標について

当社グループは、企業価値の向上に向けて経営成績の推移を把握するため、調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益を重要な経営指標として位置付けております。調整の内容につきましては、決算短信に記載しております。調整後営業利益、調整後当期(四半期)利益につきましては、同様または類似の名称を用いている他社の経営指標と内容が異なる場合があります、比較可能性がない場合があります。

■ 会計基準について

当社グループは2021年3月期より国際会計基準(IFRS)に基づいて連結財務諸表を作成しております。

■ 数字の処理について

本資料に記載された金額(一部を除く)は、億円未満を四捨五入しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。



2026年3月期連結決算概要

2026年3月期連結決算概要

- 半導体デバイス市場は、生成AI用途の高性能Logic、DRAMを中心に世代交代・生産規模拡大投資が高水準で推移。NANDは世代交代投資が中心。民生電子機器向けや自動車・産業機器向けの需要回復は緩やか。
- 当社26/3期は、前期に集中した中国地場DRAM向け装置販売が落ちついた影響により前期比で減収減益。2Q決算発表時に修正した業績予想からは売上・利益ともに上振れて着地。

2027年3月期連結業績予想と今後の見通し

- 半導体デバイスメーカーは高性能デバイス向けを中心に、世代交代や生産規模拡大に向けた設備投資をさらに加速する見通し。
- デバイスメーカーの積極的な設備投資を背景に、当社27/3期は前年同期比で増収増益を予想。先端デバイス向け装置の技術優位性を生かし、WFE成長を上回る成長をめざす。

連結業績サマリー

4Q、通期業績ともに前年同期比で減収減益。しかしながら2Q決算時に修正した通期業績予想からは、売上・利益ともに上振れて着地。期末配当については利益の上振れにより1円増配、19円とする。

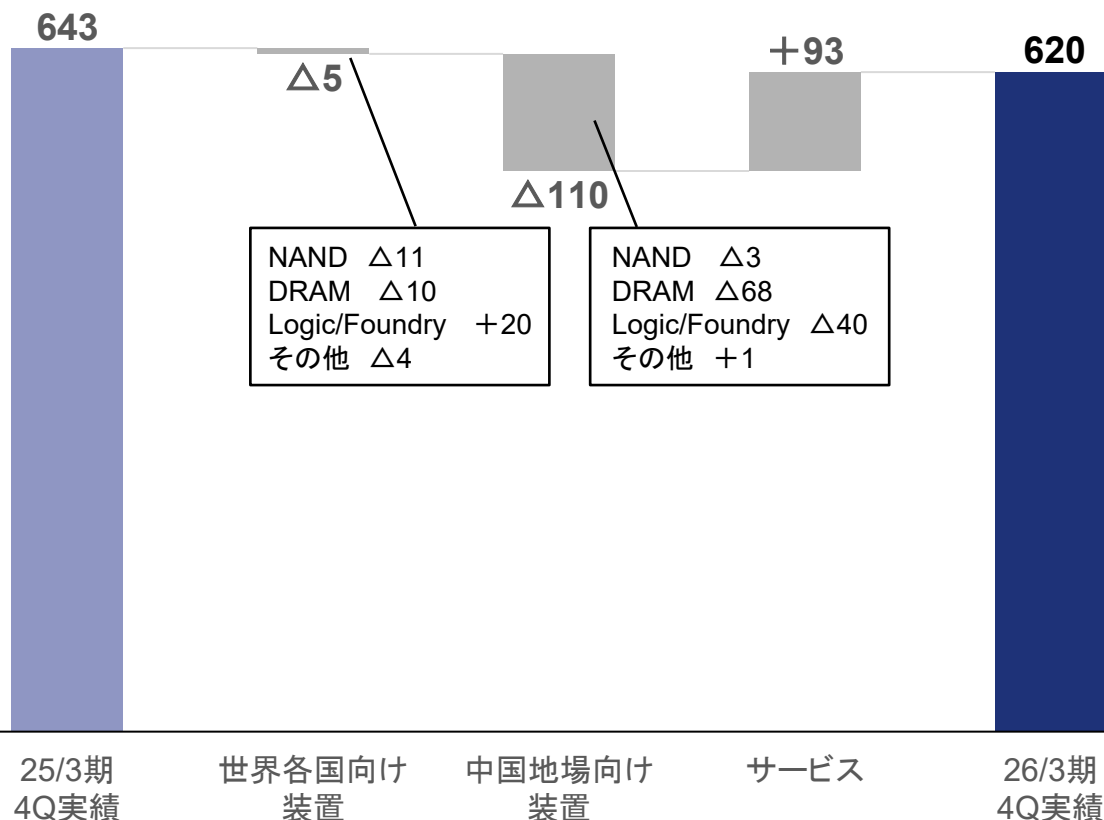
(億円)	25/3期					26/3期							
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	前年同期比	通期	前年同期比	従来予想
売上収益	652	493	601	643	2,389	518	654	559	620	△3.5%	2,351	△1.6%	2,300
売上総利益	294	220	249	255	1,017	222	273	229	244	△4.2%	968	△4.8%	935
売上総利益率	45.0%	44.6%	41.4%	39.7%	42.6%	42.9%	41.7%	41.0%	39.4%	△0.3pts	41.2%	△1.4pts	40.7%
調整後営業利益	194	113	139	132	578	109	144	113	110	△16.9%	476	△17.6%	444
調整後営業利益率	29.7%	22.9%	23.1%	20.5%	24.2%	21.1%	22.1%	20.2%	17.7%	△2.9pts	20.2%	△4.0pts	19.3%
調整後当期(四半期)利益	143	73	96	111	423	76	98	83	84	△23.8%	341	△19.4%	318
調整後当期(四半期)利益率	22.0%	14.7%	16.0%	17.2%	17.7%	14.7%	15.0%	14.8%	13.6%	△3.6pts	14.5%	△3.2pts	13.8%
営業利益	179	96	123	116	513	97	130	98	93	△19.7%	418	△18.5%	388
営業利益率	27.4%	19.4%	20.4%	18.1%	21.5%	18.8%	19.9%	17.6%	15.0%	△3.1pts	17.8%	△3.7pts	16.9%
税引前当期(四半期)利益	177	102	112	116	508	93	128	94	92	△21.0%	407	△19.8%	376
税引前当期(四半期)利益率	27.2%	20.7%	18.7%	18.1%	21.3%	18.0%	19.6%	16.9%	14.8%	△3.3pts	17.3%	△4.0pts	16.3%
当期(四半期)利益	133	48	80	99	360	68	88	73	73	△26.8%	301	△16.4%	279
当期(四半期)利益率	20.4%	9.6%	13.3%	15.5%	15.1%	13.1%	13.4%	13.0%	11.7%	△3.7pts	12.8%	△2.3pts	12.1%
研究開発費	33	39	38	46	156	39	48	42	54	+18.5%	183	+17.0%	-
設備投資額	112	30	25	36	203	23	52	40	53	+47.2%	169	△17.1%	-
減価償却費	29	30	33	34	126	34	35	36	37	+11.2%	143	+13.1%	-
1株当たり配当金(円)	-	18	-	19	37	-	18	-	19	-	37	0円	36

2026年3月期第4四半期実績 増減要因

4Qは、DRAM向けアップグレード改造(サービス)が増加した一方で、中国地場向け装置販売等が減少したため、全体の売上収益は前年同期比4%減。調整後営業利益は前年同期比17%減。

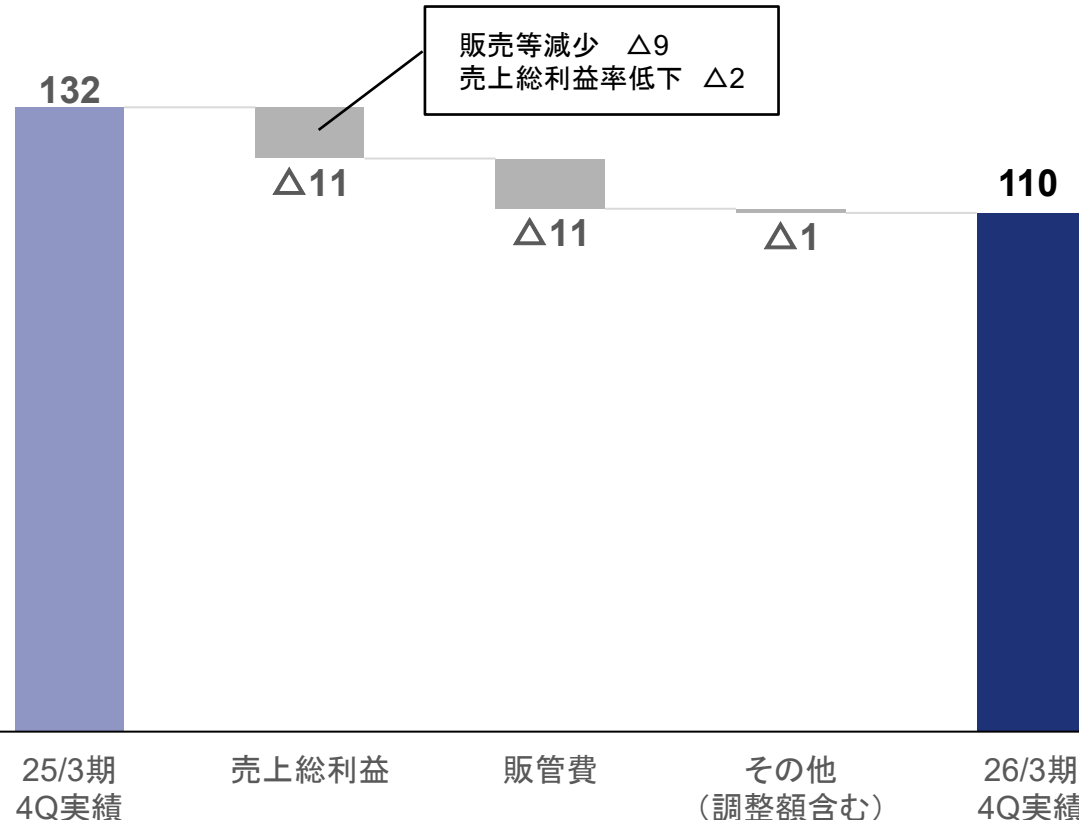
売上収益

(億円)



調整後営業利益

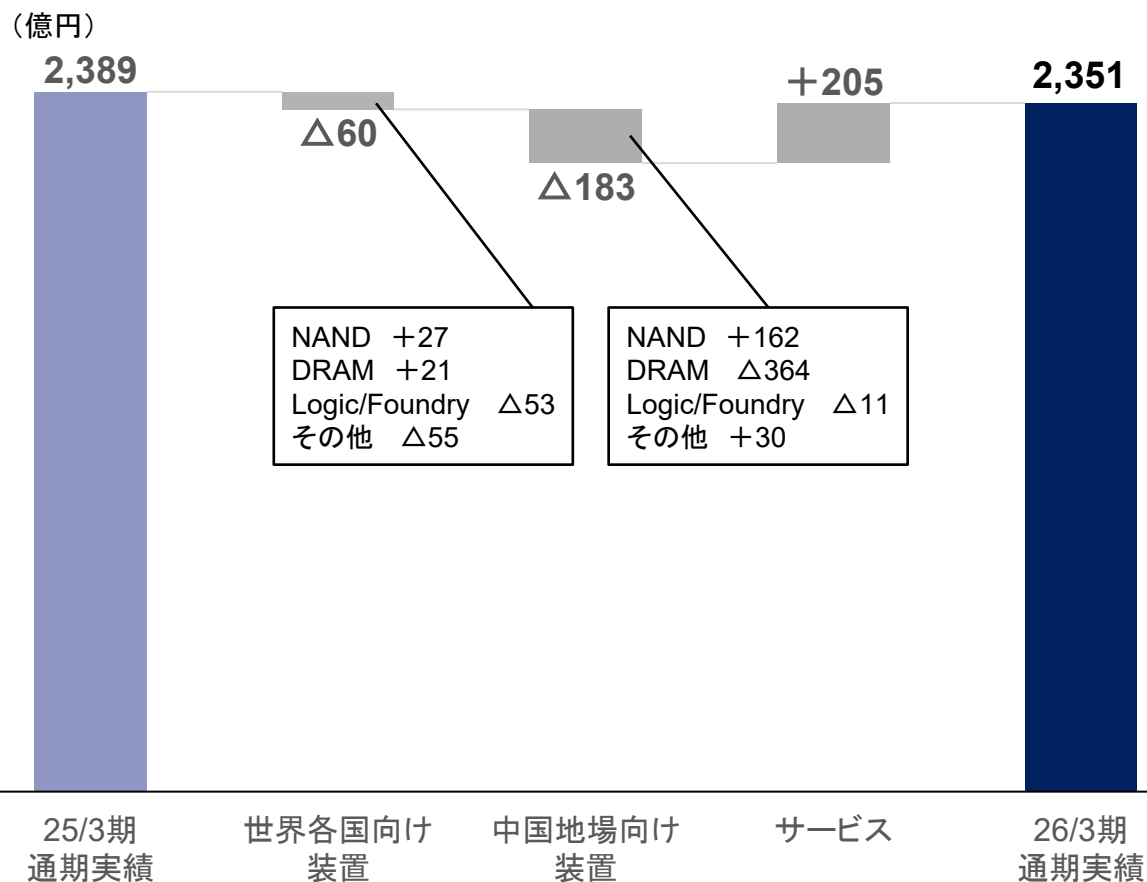
(億円)



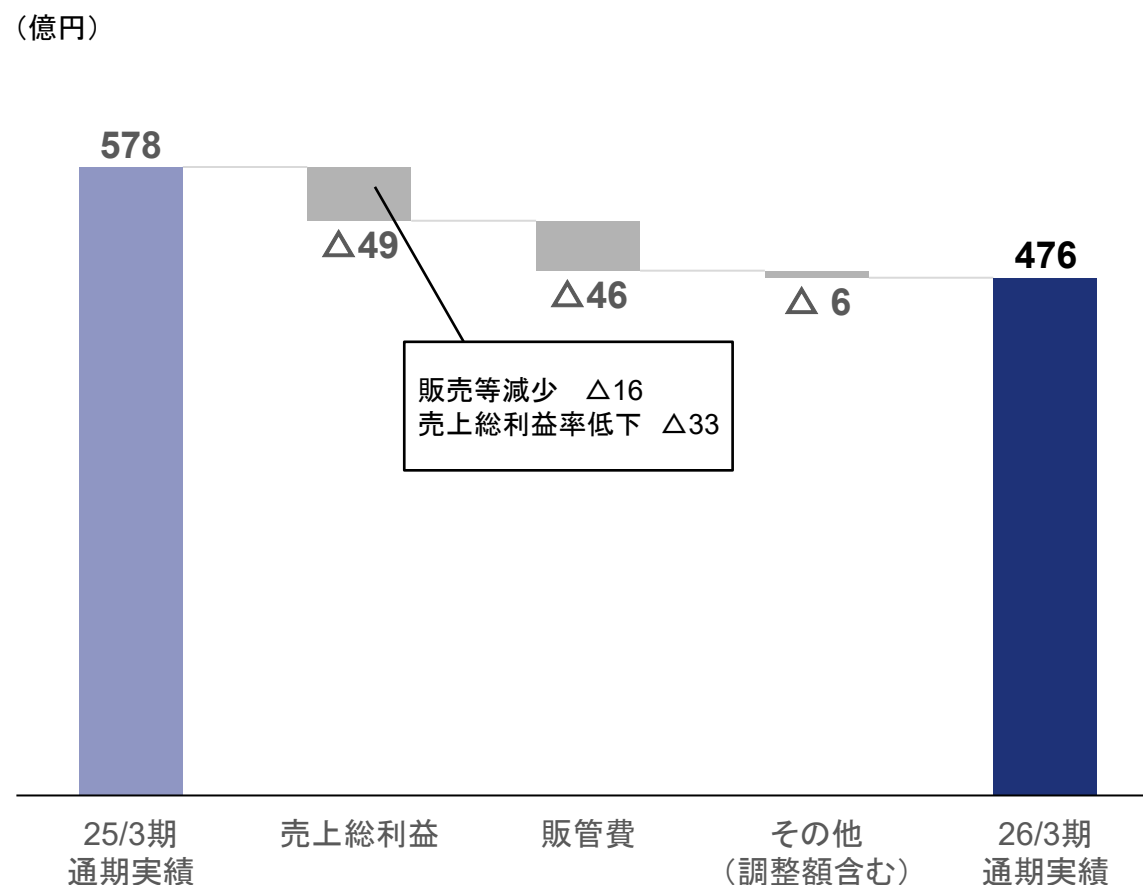
2026年3月期通期業績 増減要因

通期は、DRAM向けアップグレード改造(サービス)の増加が装置販売の減少を相殺し、全体の売上収益は前期比2%の微減。生産稼働率低下および製品構成の変化による売上総利益の減少、販管費の増加により、調整後営業利益は前年同期比18%減。

売上収益

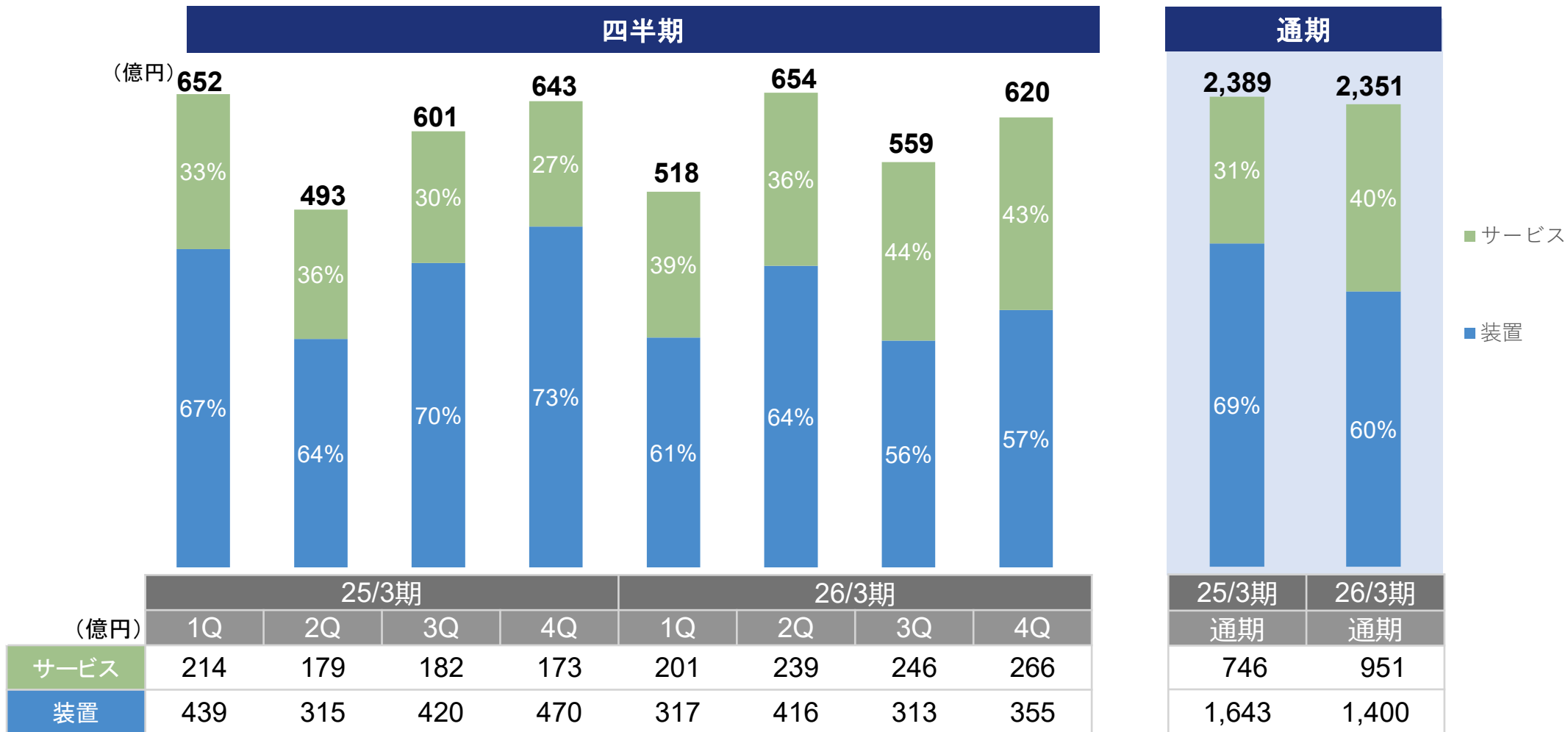


調整後営業利益



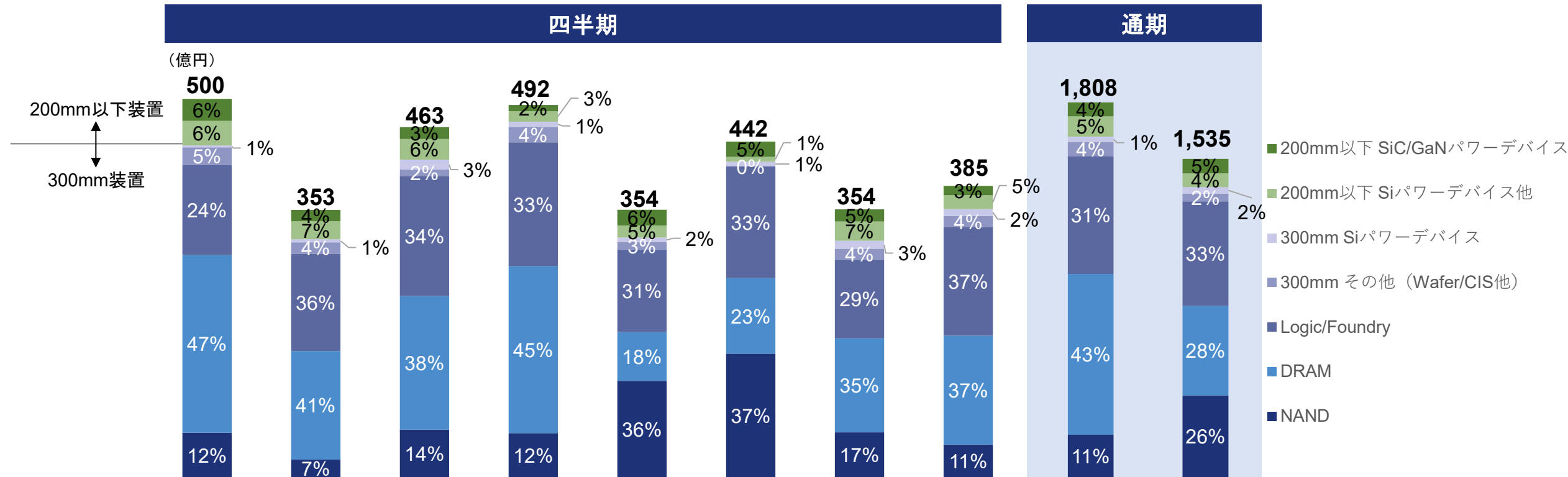
四半期別売上収益 ビジネス別

4Q・通期ともに、装置販売の一部がアップグレード改造(サービス)に置き換わった影響により、前年同期比で装置売上が減少、サービス売上が増加。通期装置売上比率は60%、サービス売上比率は40%に。



四半期別売上収益 アプリケーション別(300mm装置+200mm以下装置)

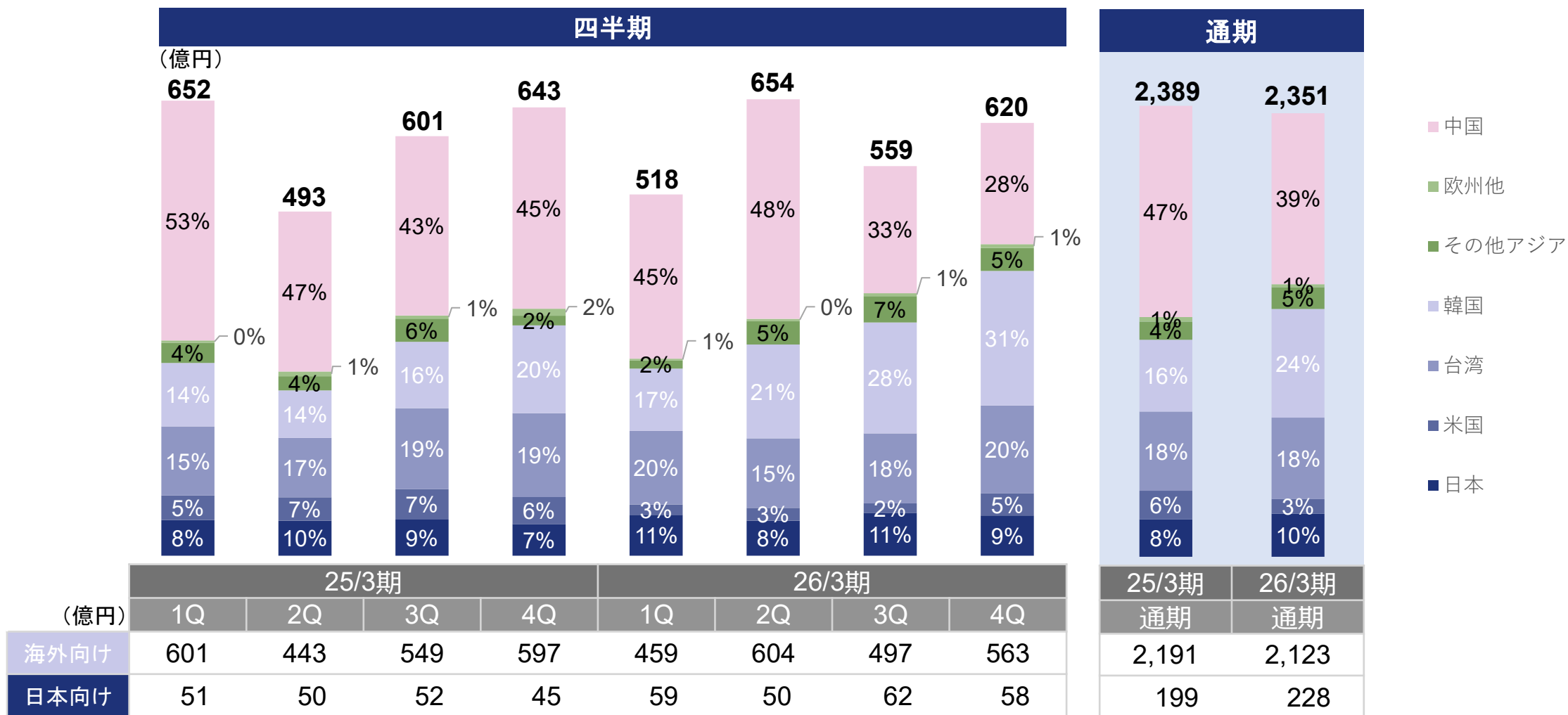
4Qは、前年同期比で主要アプリケーション向け装置販売が減少も、直前四半期比ではDRAM、Logic/Foundry向けが増加。通期は、前期比でNAND向けが90%増、DRAM向けは44%減、Logic/Foundry向けは11%減。



アプリケーション	25/3期				26/3期				25/3期	26/3期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	通期
200mm以下装置	62	39	43	22	37	26	42	31	165	136
300mm装置	439	315	420	470	317	416	313	355	1,643	1,400
合計	500	353	463	492	354	442	354	385	1,808	1,535

四半期別売上収益 仕向地別

4Qは前年同期比、直前四半期比ともに台湾、韓国向け売上が増加し、中国向け売上は減少。
 米国向け売上比率は通期で3%、中国向け売上比率は39%に低下。

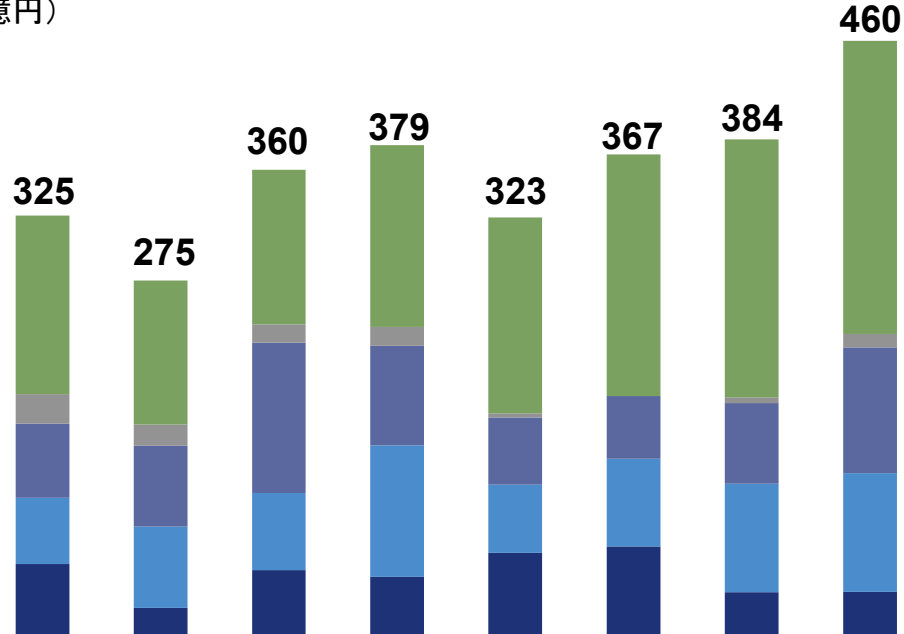


四半期別売上収益 アカウント別*1

4Qの世界各国向け売上は、直前四半期比ですべてのアプリケーション向け装置売上とサービス売上が増加。中国地場向け売上は、直前四半期比でNAND向けが減少し、DRAM、Logic/Foundry向け装置売上が増加。世界各国向け売上の伸長により中国地場向け売上比率は26%に低下。

世界各国向け売上収益

(億円)

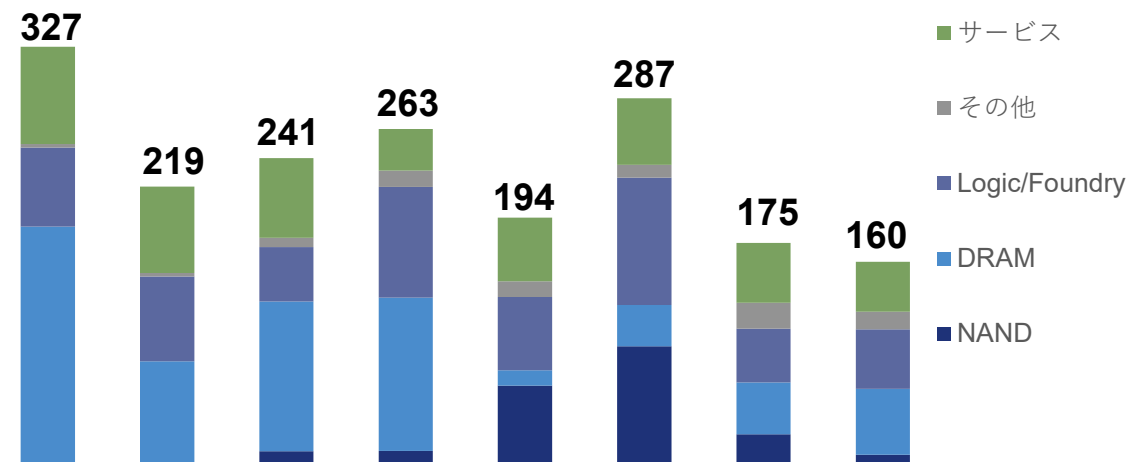


世界各国
比率

25/3期	26/3期						
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
50%	56%	60%	59%	62%	56%	69%	74%

中国地場向け売上収益

(億円)



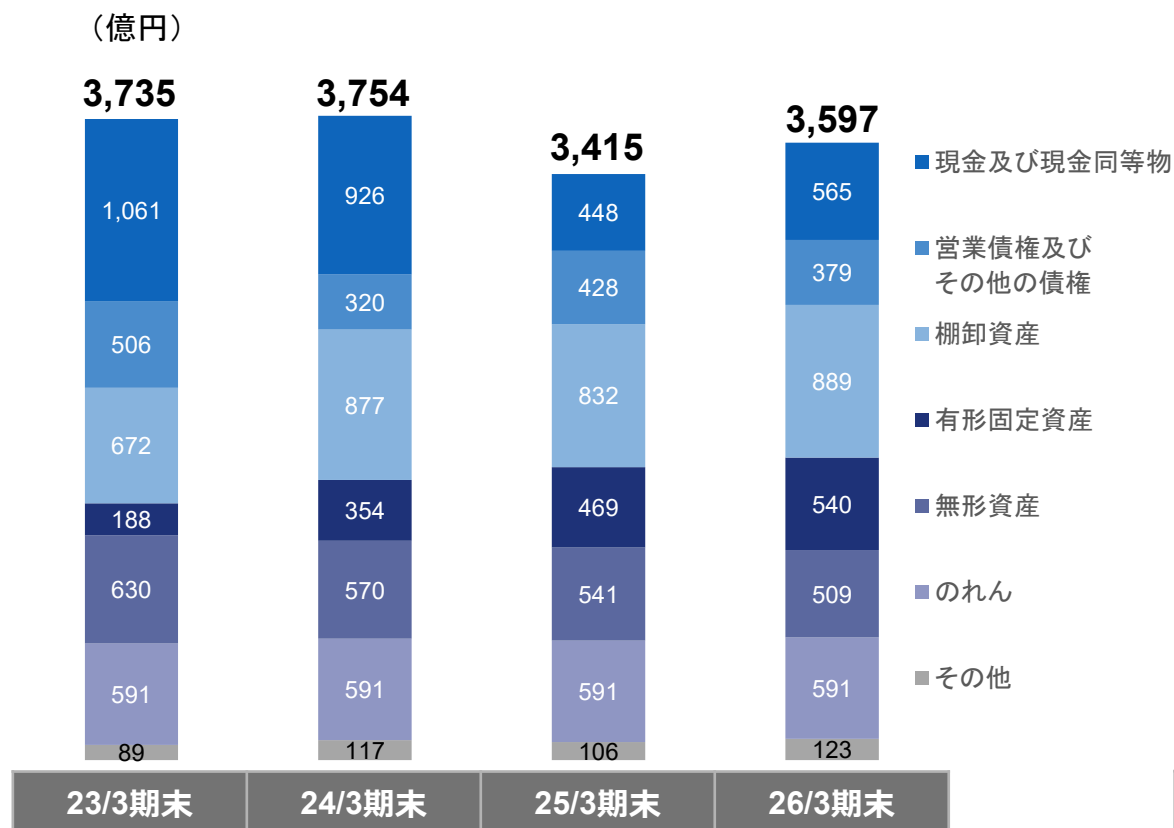
中国地場
比率

25/3期	26/3期						
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
50%	44%	40%	41%	38%	44%	31%	26%

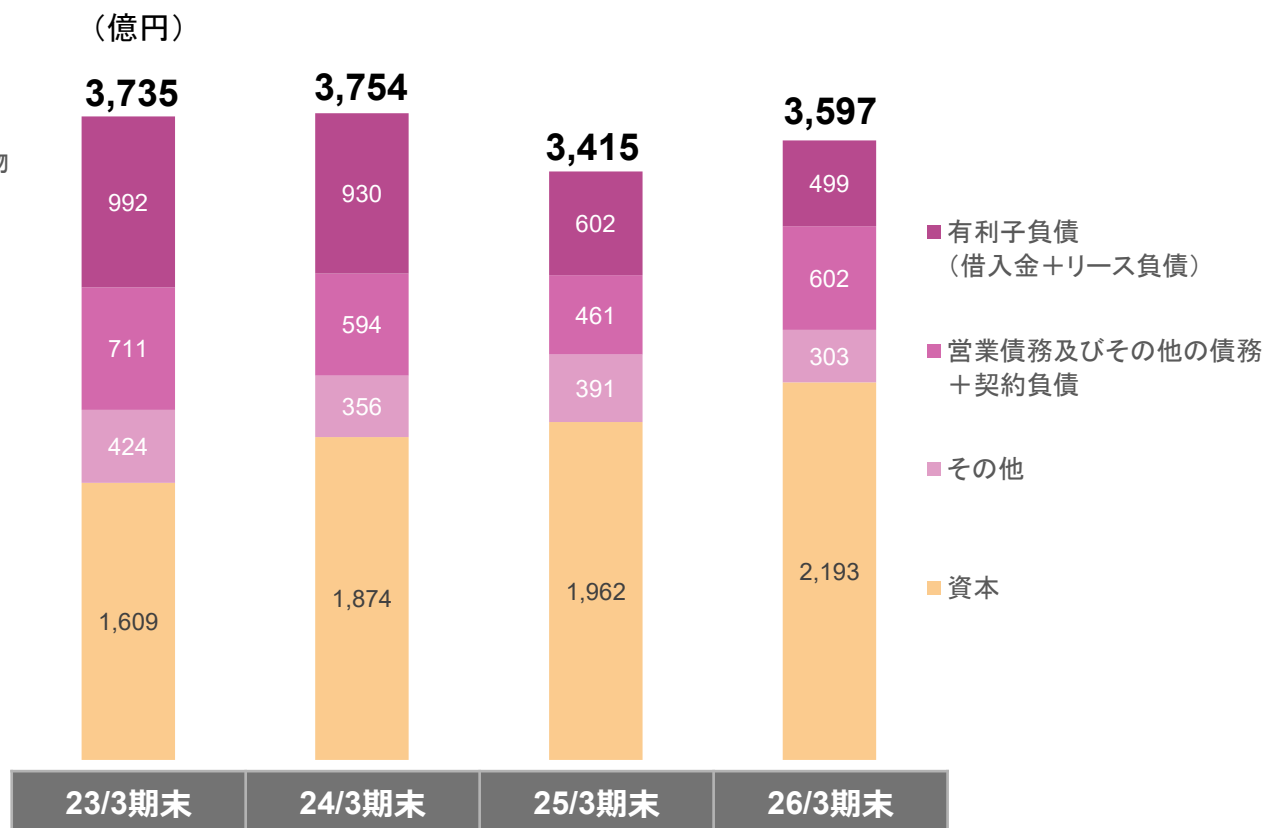
貸借対照表

当期末の資産合計は、現金等の増加、米国デモセンター設立に伴う投資等による有形固定資産の増加により前期末比で181億円増加。資本合計は利益剰余金の増加等により、前期末比で231億円増加。

資産



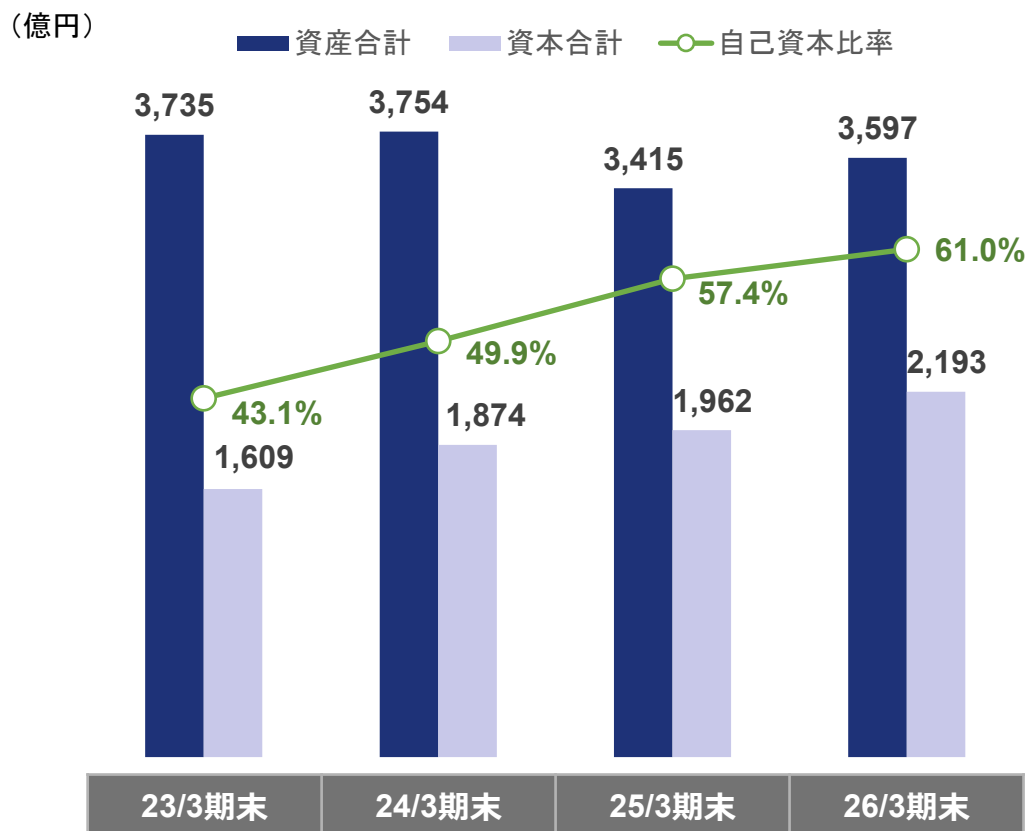
負債・資本



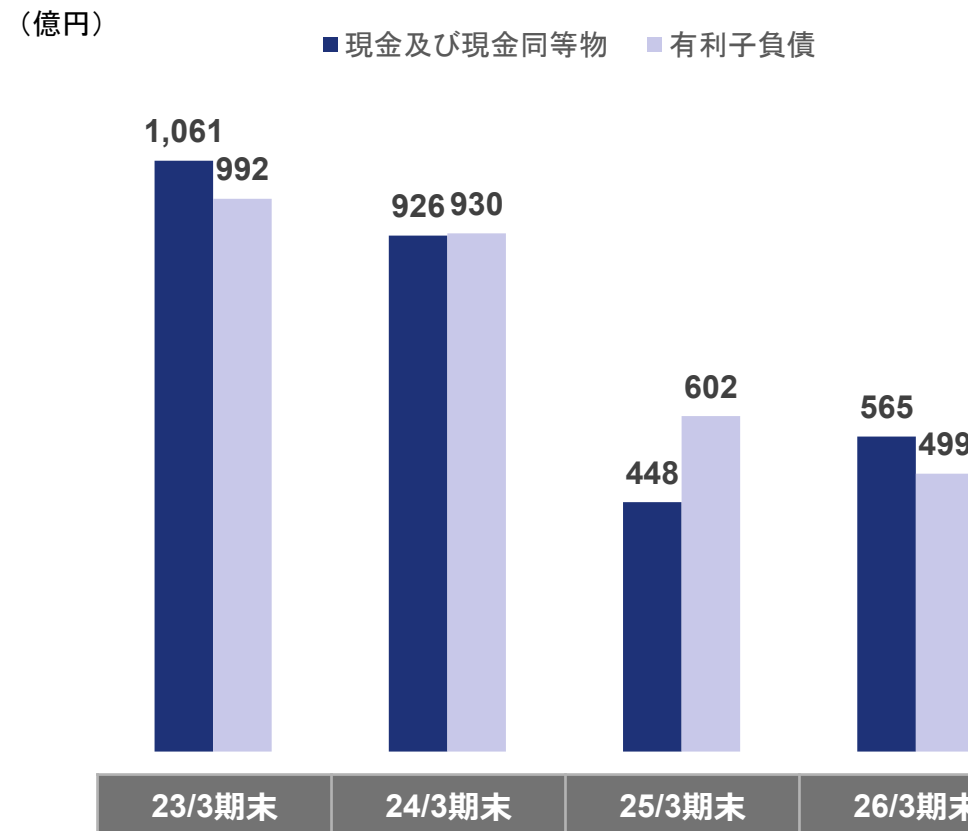
自己資本比率 & 現金及び現金同等物 / 有利子負債

当期末の自己資本比率は61%に上昇。現金等の増加に加え借入金の返済による有利子負債の減少によりネットデットを解消し、当期末のネットキャッシュは66億円に。

資産合計 / 資本合計 / 自己資本比率

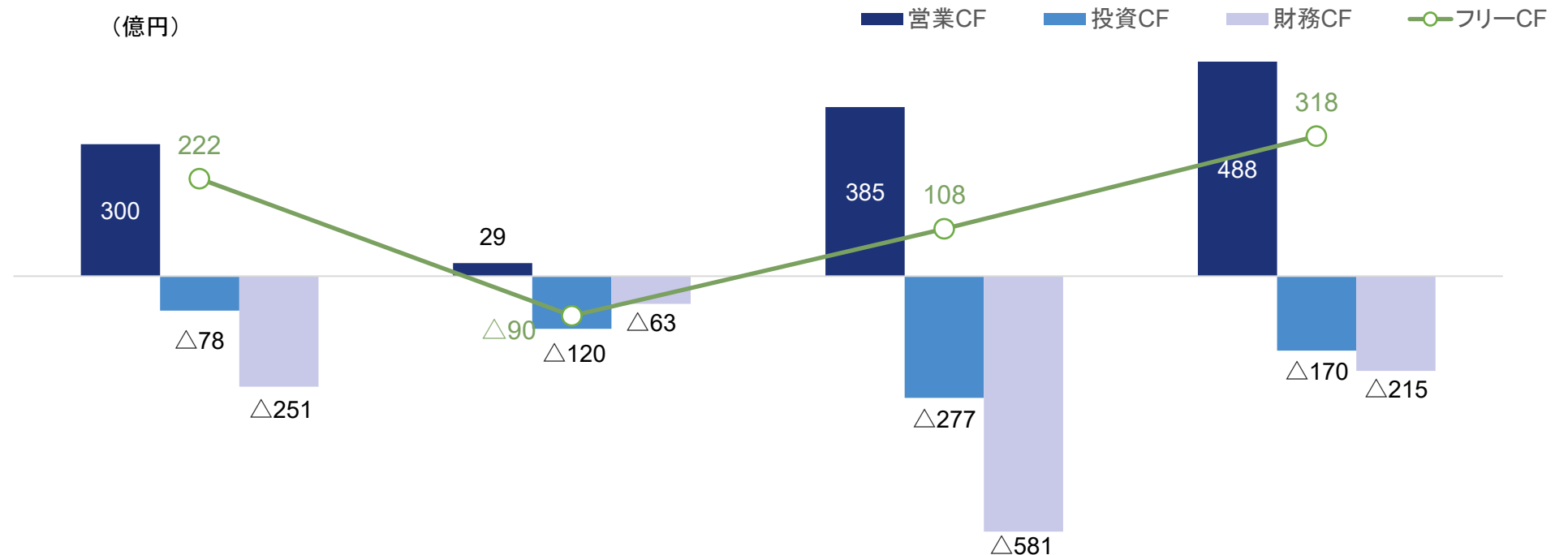


現金及び現金同等物 / 有利子負債



キャッシュ・フロー

営業CFが投資CFを上回り、フリーCFは318億円の収入。
 財務CFは借入金の返済と配当金の支払いによる支出等により、215億円の支出。



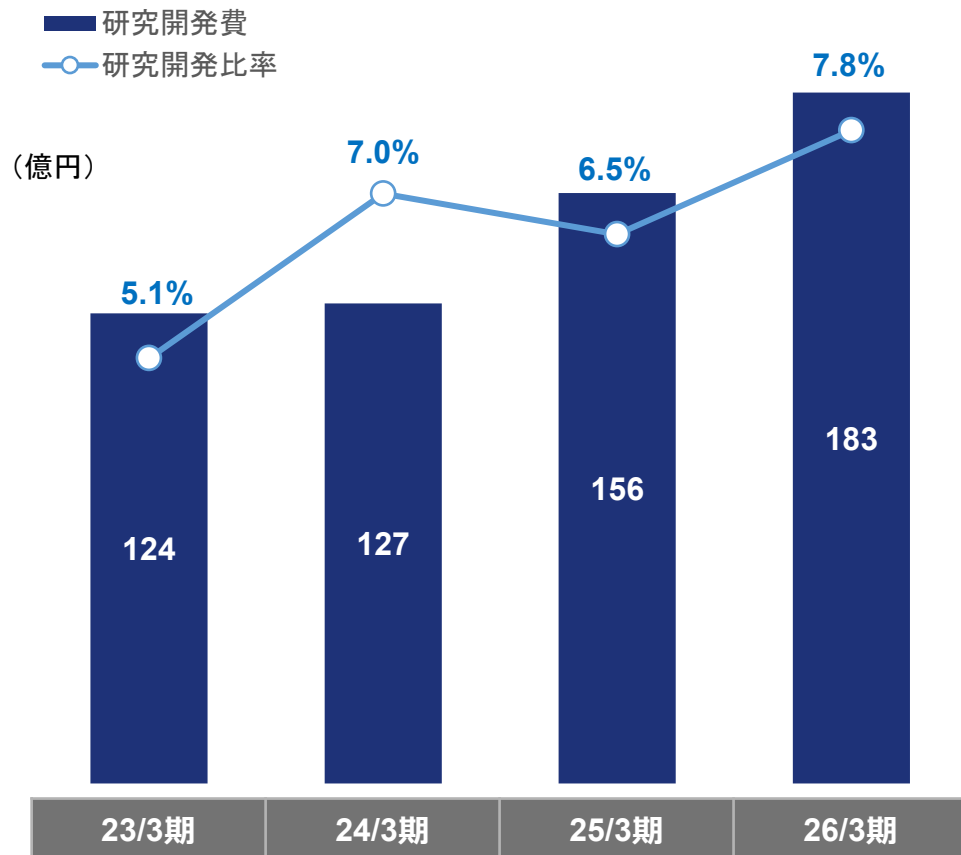
(億円)

	23/3期	24/3期	25/3期	26/3期
営業CF	300	29	385	488
投資CF	△78	△120	△277	△170
財務CF	△251	△63	△581	△215
フリーCF	222	△90	108	318
現金及び現金同等物残高	1,061	926	448	565

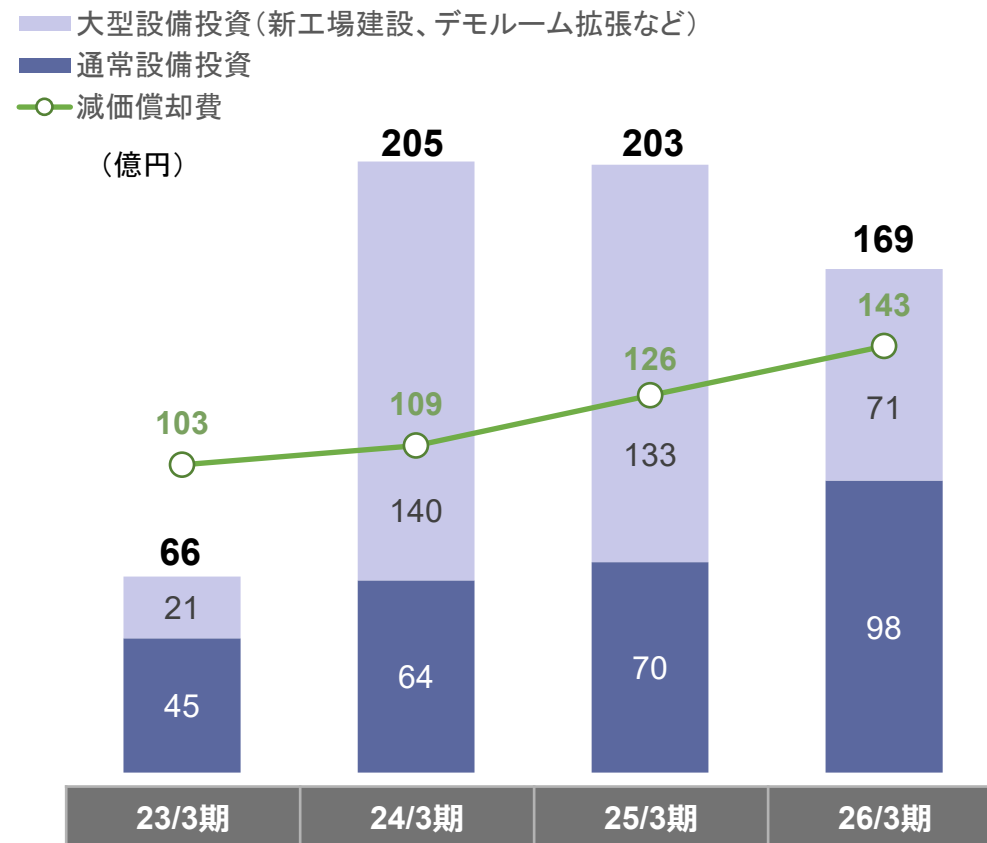
研究開発費／設備投資／減価償却費

中長期的な需要拡大を見据え、中計に沿って研究開発投資、設備投資を実施。
 研究開発費は前期比2割増。設備投資は前期比2割減、減価償却費は前期比1割増。

研究開発費



設備投資／減価償却費





2027年3月期連結業績予想

2026年3月期連結決算概要

- 半導体デバイス市場は、生成AI用途の高性能Logic、DRAMを中心に世代交代・生産規模拡大投資が高水準で推移。NANDは世代交代投資が中心。民生電子機器向けや自動車・産業機器向けの需要回復は緩やか。
- 当社26/3期は、前期に集中した中国地場DRAM向け装置販売が落ちついた影響により前期比で減収減益。2Q決算発表時に修正した業績予想からは売上・利益ともに上振れて着地。

2027年3月期連結業績予想と今後の見通し

- 半導体デバイスメーカーは高性能デバイス向けを中心に、世代交代や生産規模拡大に向けた設備投資をさらに加速する見通し。
- デバイスメーカーの積極的な設備投資を背景に、当社27/3期は前年同期比で増収増益を予想。先端デバイス向け装置の技術優位性を生かし、WFE成長を上回る成長をめざす。

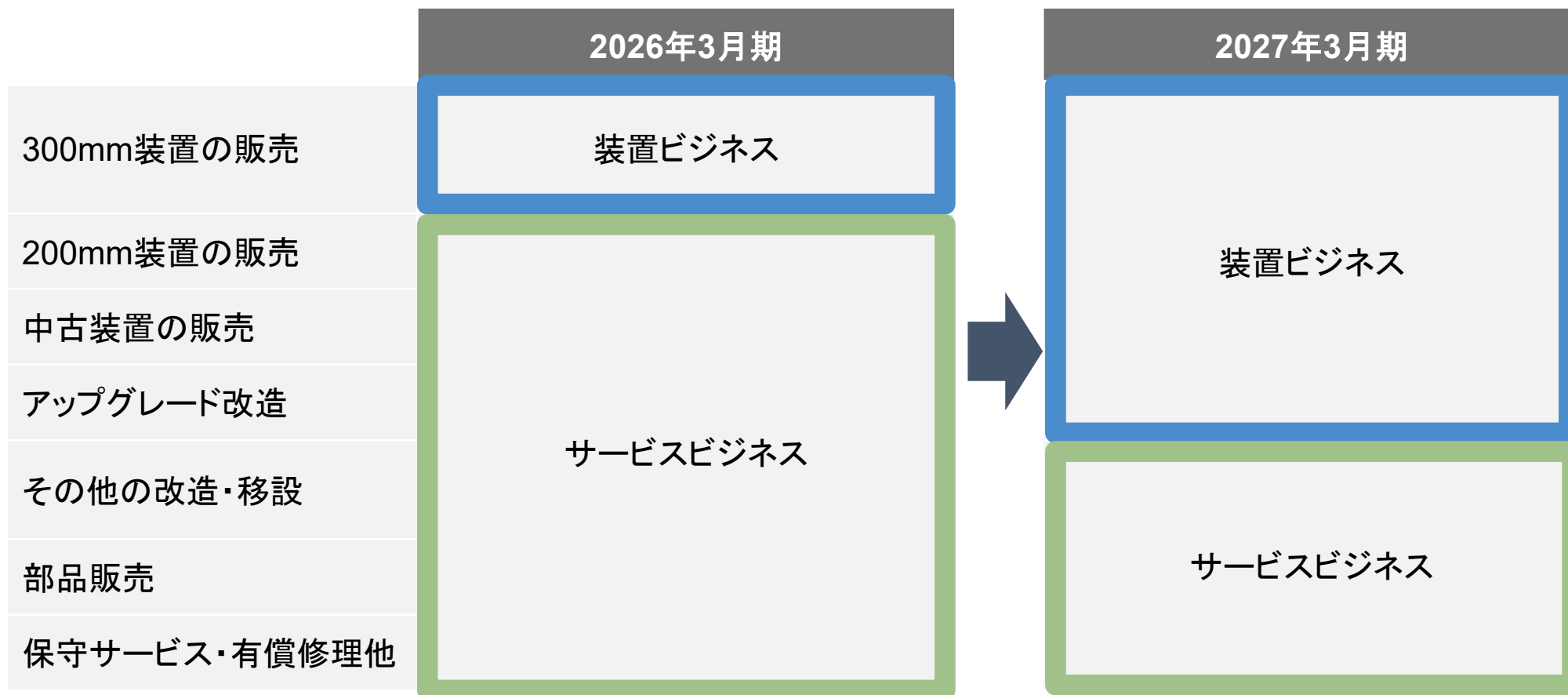
2027年3月期業績・配当予想

デバイスメーカーの積極的な設備投資を背景に、当社は先端デバイス向け装置の技術優位性を生かし、前期比で増収増益を予想。配当金は調整後当期利益ベースの配当性向25.6%の47円を予想。

(億円)	26/3期			27/3期			
	上期実績	下期実績	通期実績	上期予想	下期予想	通期予想	前期比
売上収益	1,172	1,179	2,351	1,523	1,277	2,800	+19.1%
売上総利益	495	473	968	641	535	1,176	+21.6%
売上総利益率	42.2%	40.1%	41.2%	42.1%	41.9%	42.0%	+0.8pts
調整後営業利益	253	223	476	355	250	605	+27.1%
調整後営業利益率	21.6%	18.9%	20.2%	23.4%	19.5%	21.6%	+1.4pts
調整後当期(半期)利益	174	167	341	250	179	429	+25.8%
調整後当期(半期)利益率	14.8%	14.2%	14.5%	16.4%	14.0%	15.3%	+0.8pts
営業利益	227	191	418	325	220	545	+30.3%
営業利益率	19.4%	16.2%	17.8%	21.4%	17.2%	19.5%	+1.7pts
税引前当期(半期)利益	222	186	407	319	215	534	+31.1%
税引前当期(半期)利益率	18.9%	15.8%	17.3%	21.0%	16.8%	19.1%	+1.8pts
当期(半期)利益	156	145	301	229	159	388	+28.9%
当期(半期)利益率	13.3%	12.3%	12.8%	15.1%	12.4%	13.9%	+1.1pts
1株当たり配当金(円)	18	19	37	23	24	47	+10円
配当性向(調整後当期利益ベース)	—	—	25.3%	—	—	25.6%	+0.3pts

ビジネス区分の変更

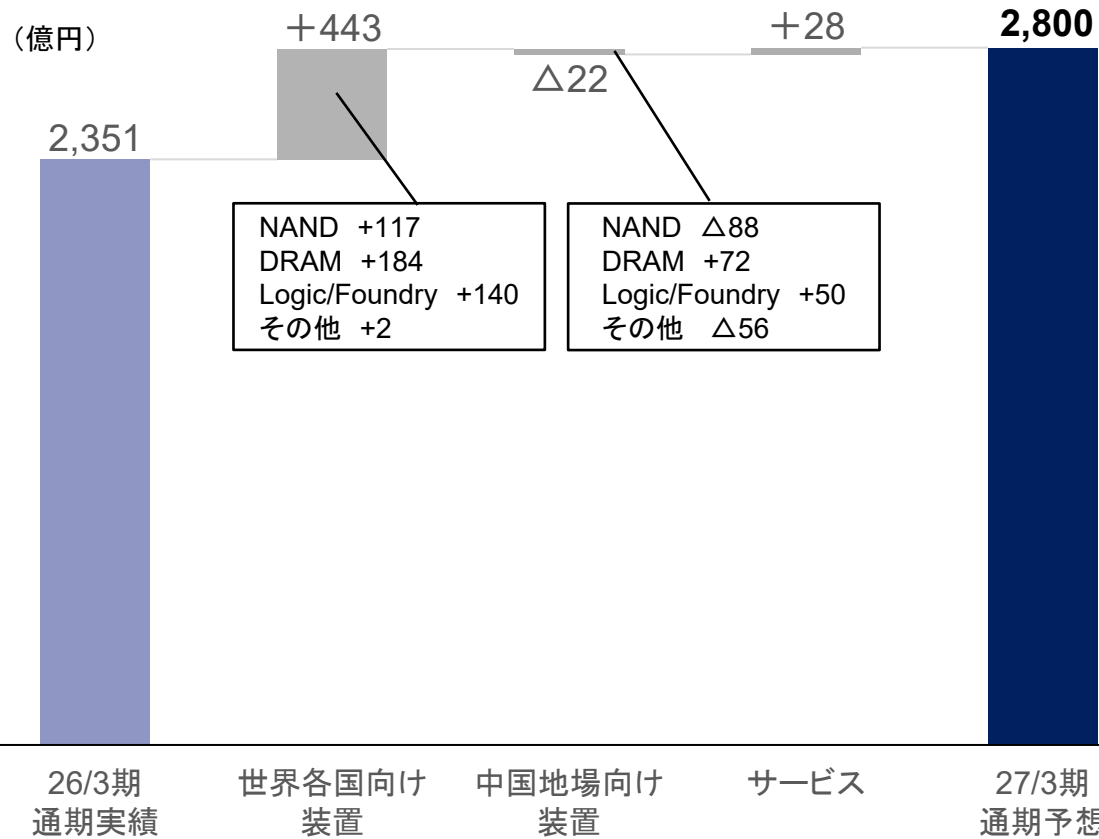
2027年3月期より、ビジネス区分を変更。これまでサービスビジネスに属していた「200mm装置の販売」と「中古装置の販売」、「アップグレード改造」を装置ビジネスに移管。よりWFE市場と連動した開示区分へ。



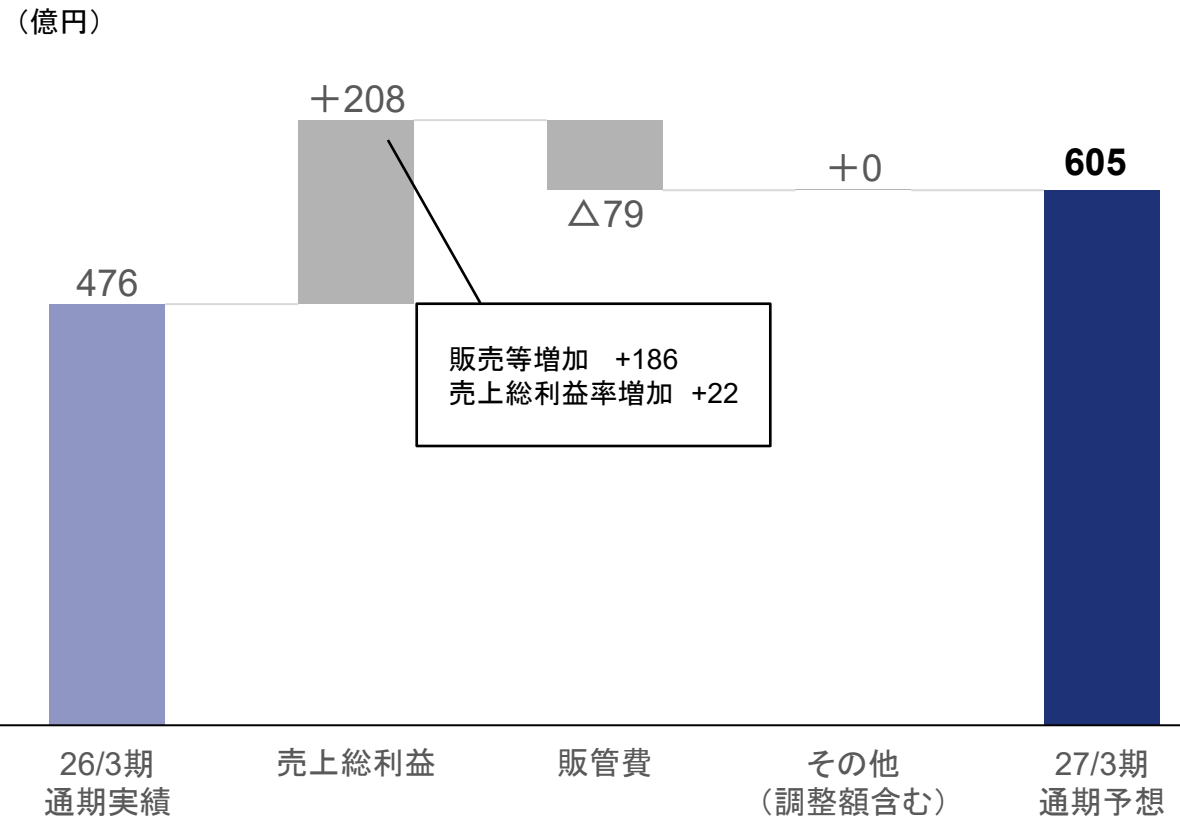
2027年3月期業績予想 増減要因(新基準*1)

売上収益は、中国地場向け装置売上が微減となるものの、世界各国向け装置売上の大幅な増加により前期比で19%増加を見込む。調整後営業利益は、販売増加と売上総利益率の上昇により27%増加を見込む。

売上収益



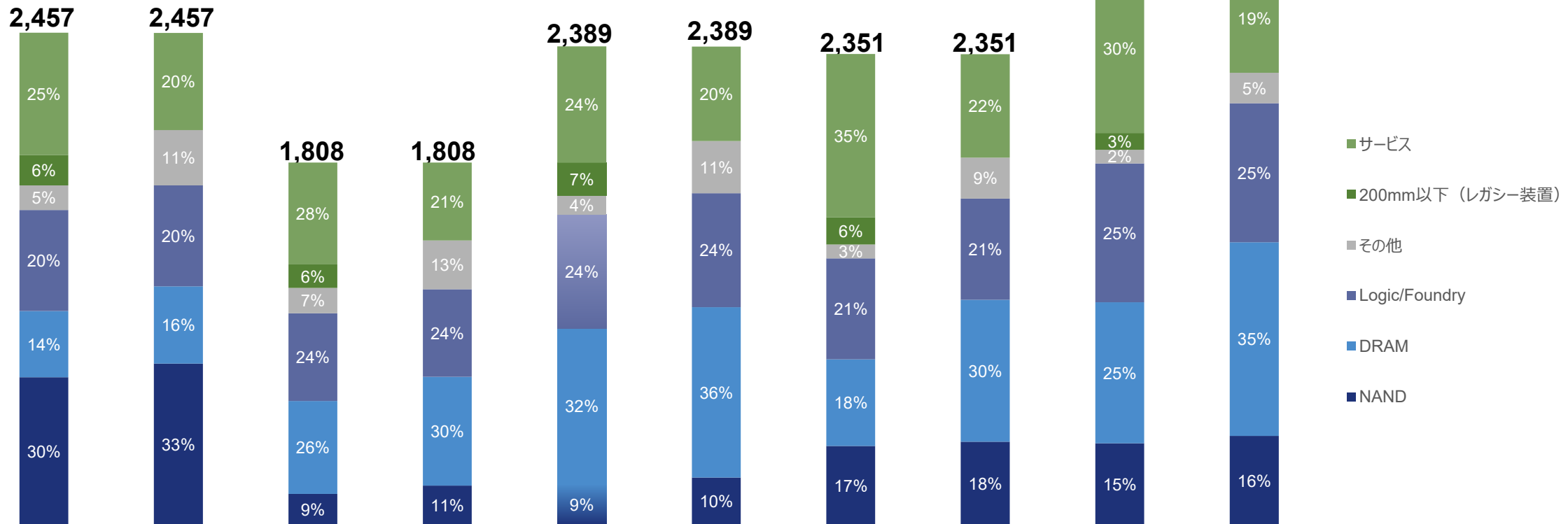
調整後営業利益



2027年3月期業績予想 アプリケーション別装置売上収益

前期比でNAND向けは7%、DRAM向けは36%、Logic/Foundry向けは38%と、それぞれ増加の見込み。
新基準でのサービス売上比率は19%の見込み。

(億円)



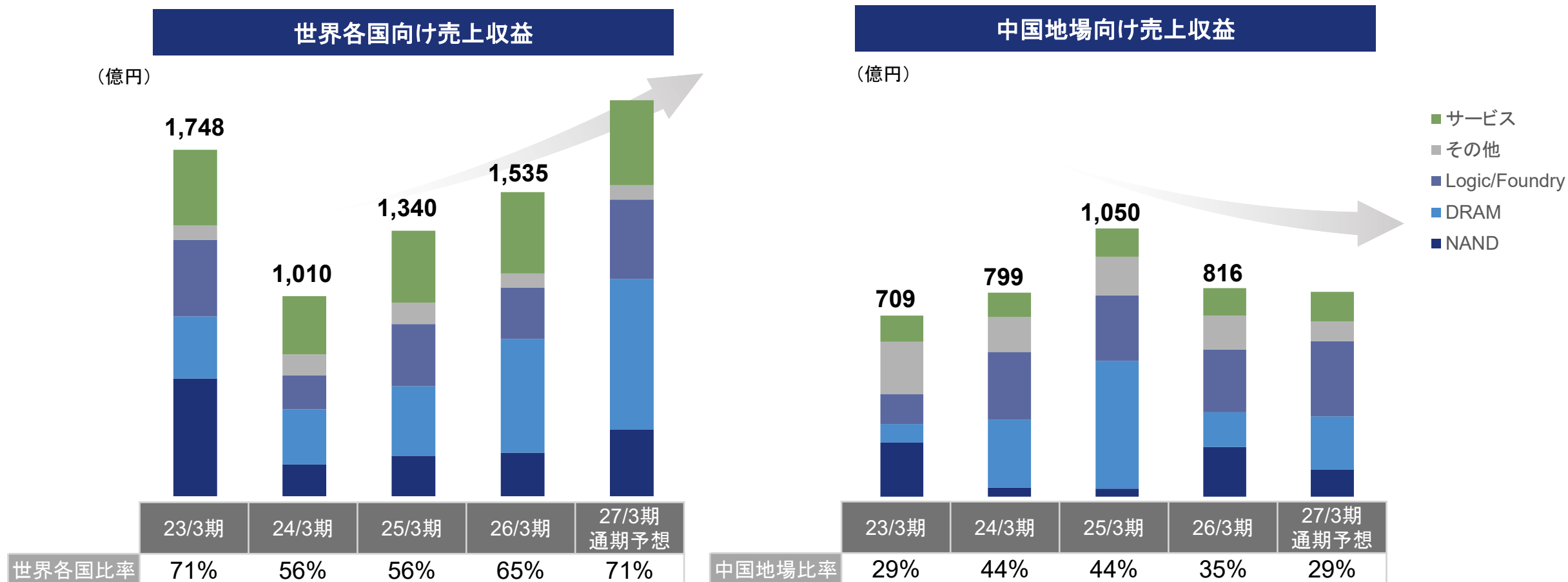
(億円)

	23/3期		24/3期		25/3期		26/3期		27/3期 通期予想	
	旧基準	新基準*1	旧基準	新基準	旧基準	新基準	旧基準	新基準	旧基準	新基準
サービス売上	762	485	625	388	746	472	951	516	927	544
装置売上	1,695	1,972	1,183	1,420	1,643	1,916	1,400	1,834	1,873	2,255

*1 「その他」に「200mm以下装置」含む。「アップグレード改造」は各アプリケーションに含む。

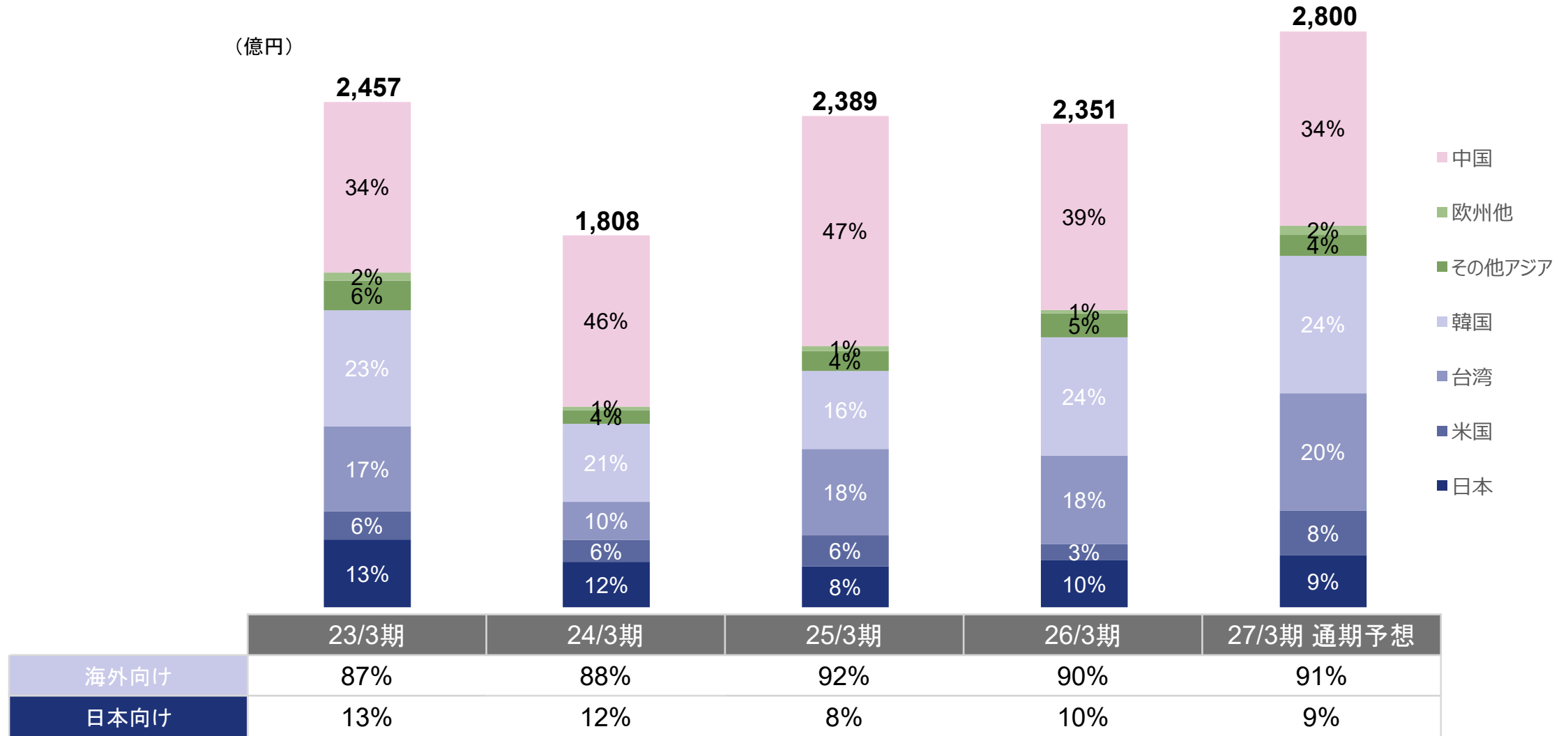
2027年3月期業績予想 アカウト別*1売上収益(新基準*2)

世界各国向け売上は、主要アプリケーション向けの大幅な増加とサービス売上の増加により、前期比30%増の見込み。中国地場向け売上は、NAND向けが投資の端境期にあたり前期比2%減少も、DRAM向けは前期比53%と大幅に回復し、Logic/Foundryも増加の見込み。中国地場向け売上比率は29%に低下。



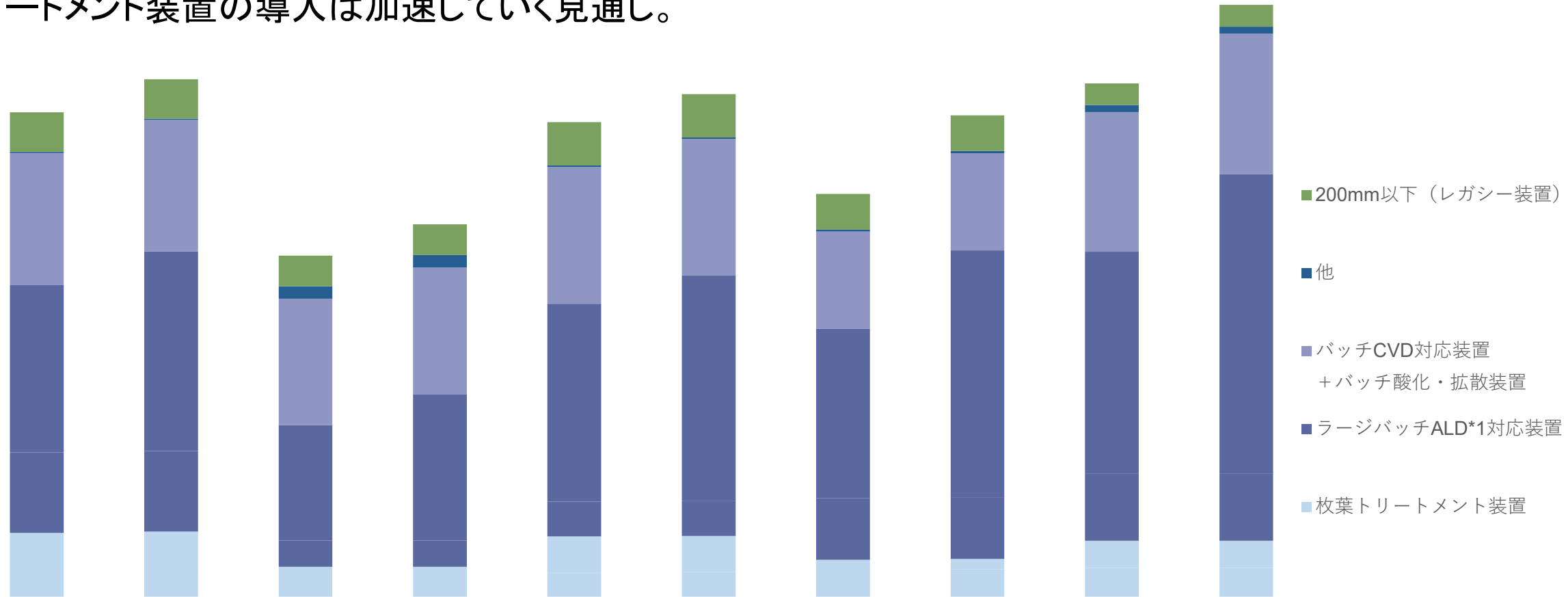
2027年3月期業績予想 仕向地別売上収益

前期比で日本、米国、台湾、韓国仕向け売上が増加。中国仕向け比率は減少し、34%の見込み。



2027年3月期業績予想 装置別売上収益

27年3月期の高付加価値製品比率は71%となる見込み。今後デバイスの世代交代によりバッチALD装置と枚葉トリートメント装置の導入は加速していく見通し。



	23/3期		24/3期		25/3期		26/3期		27/3期 通期予想	
	旧基準	新基準 ^{*2}	旧基準	新基準	旧基準	新基準	旧基準	新基準	旧基準	新基準
高付加価値製品比率	64%	67%	50%	54%	62%	64%	67%	72%	67%	71%

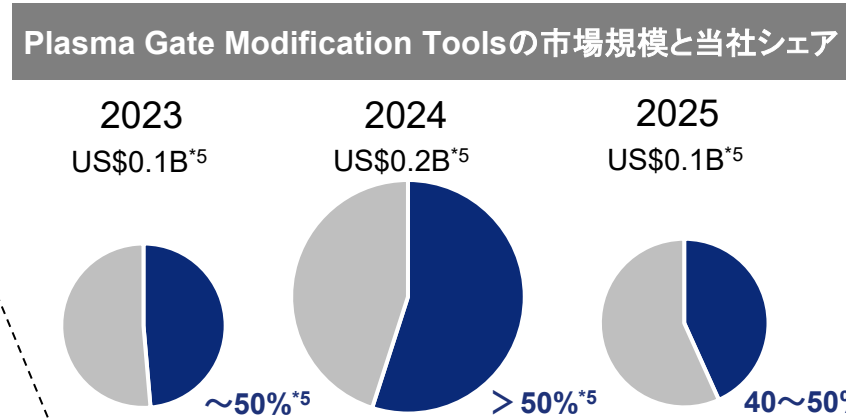
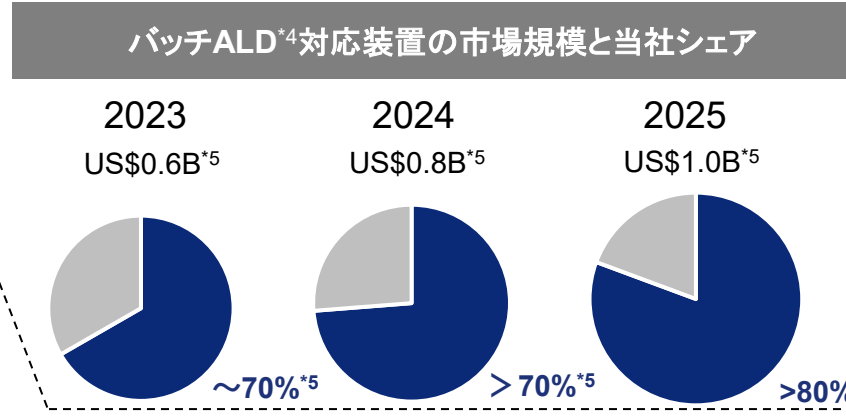
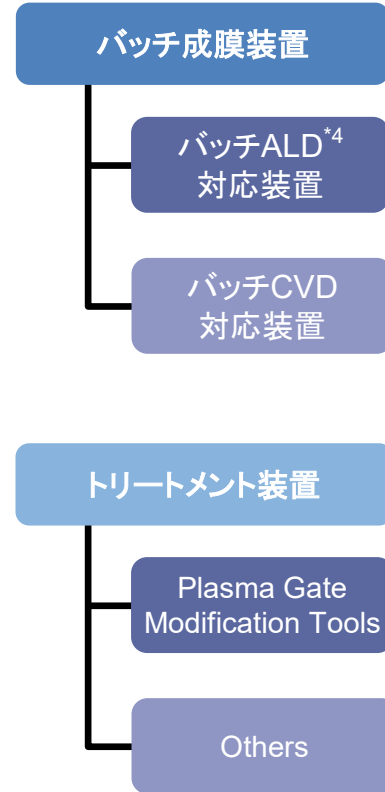
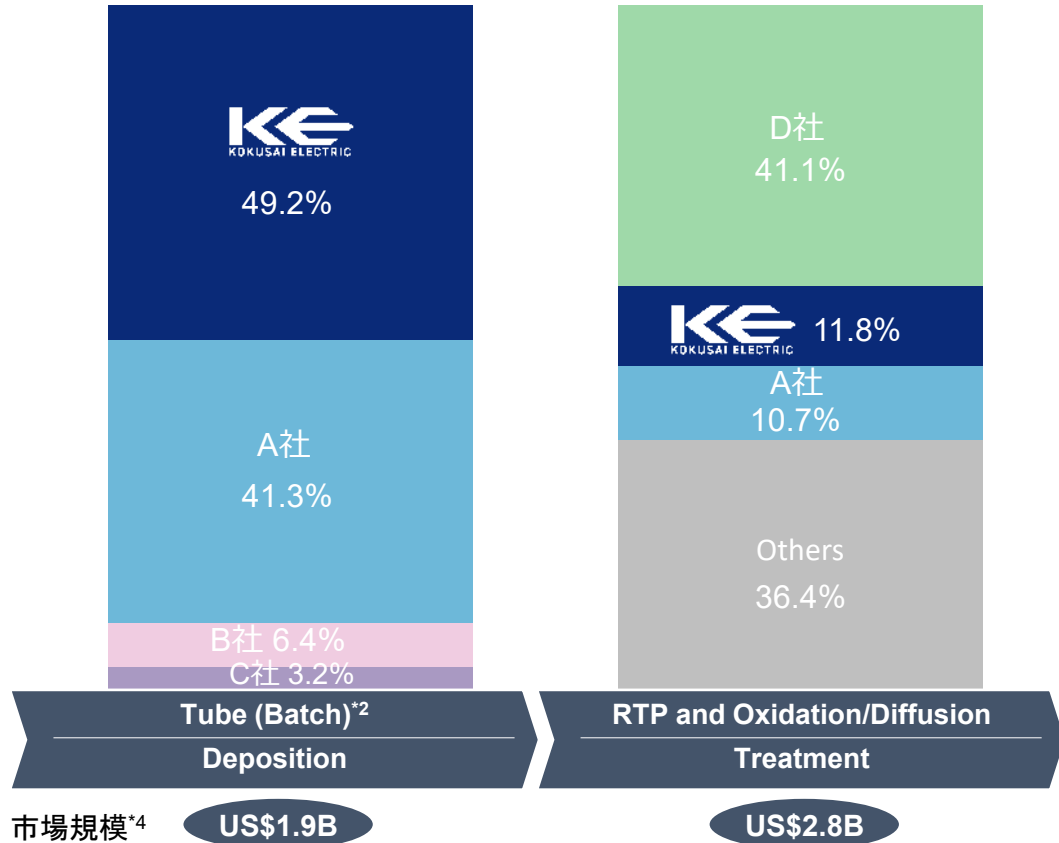


今後の見通し

マーケットシェアの推移

CY25は、バッチ成膜装置市場においてトップシェアを獲得。
 バッチALD^{*1}対応装置シェアは80%に到達、枚葉トリートメント装置 (Plasma Gate Modification Tools) もトップシェアを維持^{*2}。

(CY25) Gartnerの分類に基づく市場シェア^{*3}



^{*1} 当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。^{*2} GartnerによるWFEセグメントにおける「Tube CVD」を「Tube (Batch)」と定義 (当社にて算出) ^{*3} 出典: Gartner®, Market Share: Semiconductor Wafer Fab Equipment, Worldwide, 2025, Bob Johnson et al. Published 2 April 2026
^{*4} 図はガートナーリサーチに基づき、Kokusai Electricが作成。ここに記載のある数値は、Kokusai Electricにより算出されたものです。Treatment (トリートメント装置): RTP and Oxidation/Diffusion。GARTNERは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved. Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。本書に記載するGartnerのコンテンツ (以下「Gartnerコンテンツ」) は、Gartnerシンジケート・サブスクリプション・サービスの一部としてGartner, Inc. (以下「Gartner」) が発行したリサーチ・オピニオンまたは見解を表すものであり、事実を述べているものではありません。Gartnerコンテンツの内容はいずれも、そのコンテンツが発行された当時の内容であり、本書が発行された日の内容ではありません。また、Gartnerコンテンツに記載されている見解は予告なく変更されることがあります。^{*4} Gartnerによるカテゴリーの合計値 ^{*5} 公開情報・当社売上高に基づき当社推定

事業環境の見通し

生成AI関連の需要が引き続き市場をけん引、高性能デバイス向け装置需要はさらに強まる見通し。

半導体デバイス市場

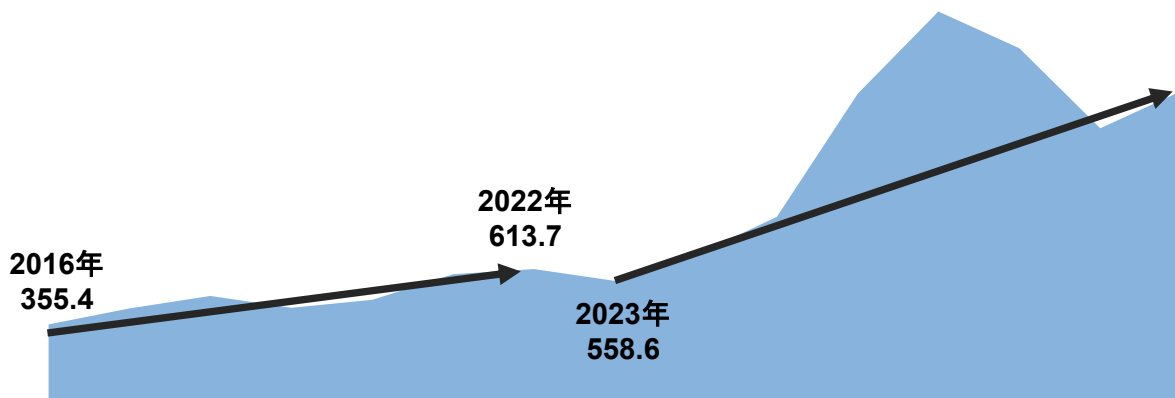
- 生成AI関連の需要が引き続きデバイスメーカーの設備投資をけん引。高性能デバイス向けの投資は増加傾向が続く見通し。
- 成熟ノード向けの設備投資は欧米亜で回復に遅れがあり、中国でも減速感が漂う中、回復の見通しに不透明感。
- 中長期的には、民生電子機器の需要回復、データセンターの拡充、グリーントランスフォーメーションへの投資等により、大きな成長に期待。

半導体製造装置(WFE)市場

- 高性能デバイス向け装置需要はさらに増加する見通し。成熟ノード向け需要は低迷。中国地場向けは大手メーカー向け需要は継続。
- CY26は前年比+15%程度の拡大を想定。
- 中長期的には半導体デバイス市場と同様に大きな成長が期待され、2030年には1,900億ドルを超える見通し。

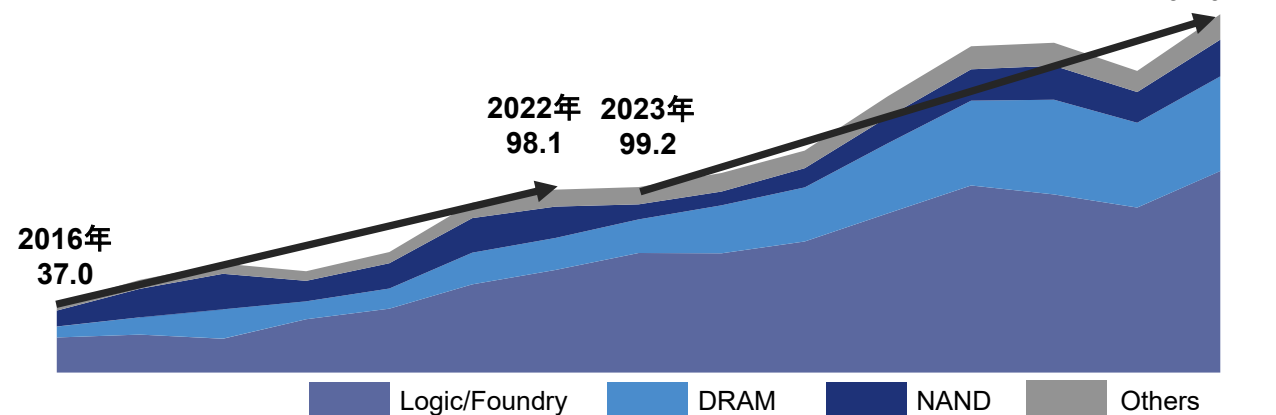
半導体デバイスの世界市場規模
(単位:US\$B)

2030年(予想)
1,268.5



半導体製造装置(WFE)の世界市場規模
(単位:US\$B)

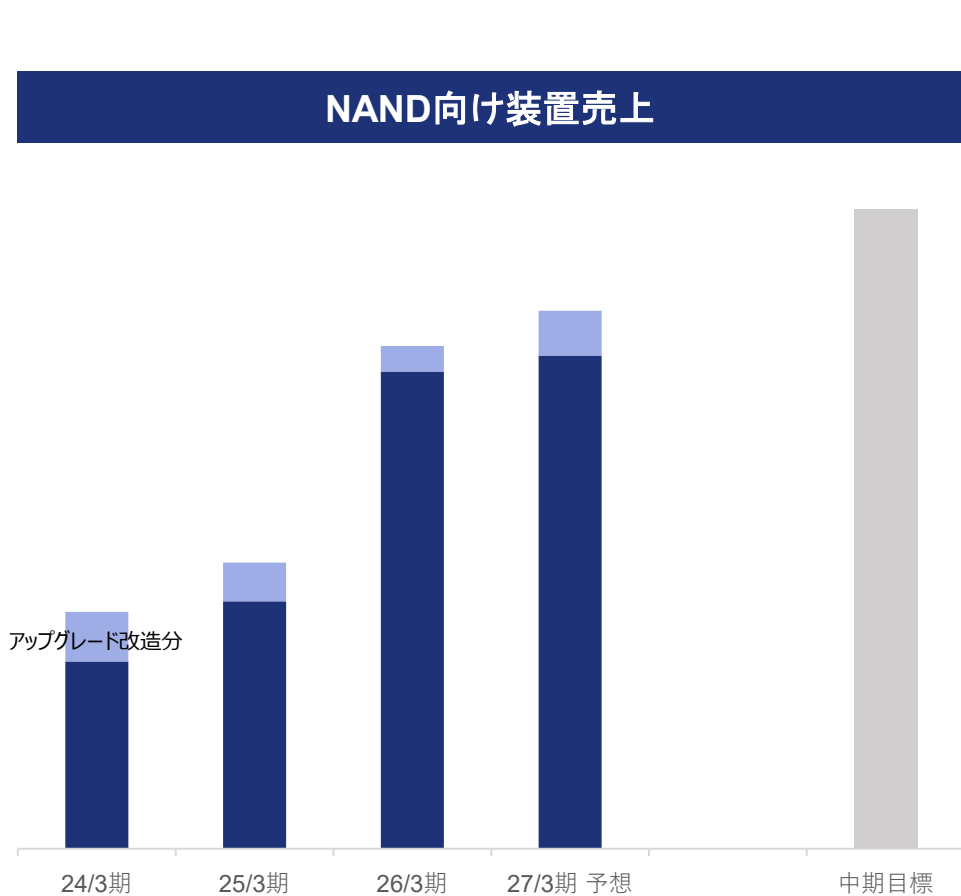
2030年(予想)
192.0



出所: Techinsights Inc. "Semiconductor Forecast" (Mar-2026)
Techinsights Inc-WAFER FAB EQUIPMENT (WFE) MARKET HISTORY AND FORECAST (2020 - 2031)_Mar-26

NAND向け装置ビジネスの現状と見通し

世界各国向けは世代交代投資(200~300層)が継続。
中国市場向けは2026年前半は端境期も後半から投資再開の見込み。



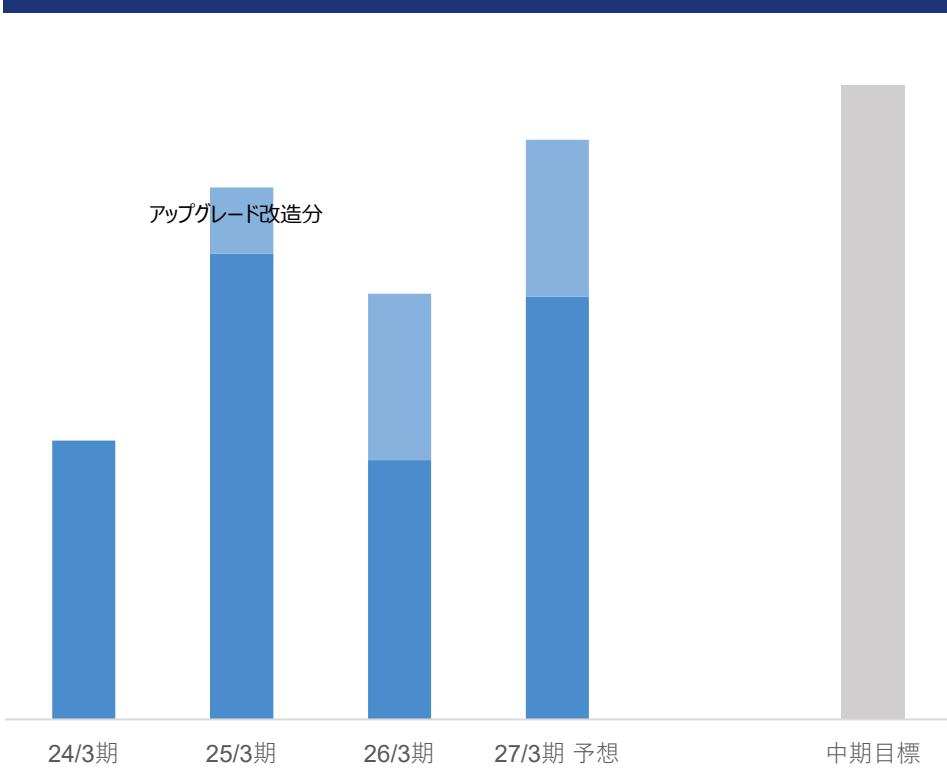
	2025	2026	2027	2028	2029
3D NAND	多層化				
	~200 layers	200~500 layers	500 layers~		
Blocking Oxide	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓		✓✓✓✓	
Charge Trap Nitride	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓		✓✓✓✓✓	
Tunnel Dielectric	✓✓✓✓✓	✓✓✓✓✓		✓✓✓✓✓	
Channel Si	✓✓	✓✓		✓	
Blocking Metal Oxide A	✓	✓✓		✓✓✓✓	
Barrier Metal A	✓	✓		✓	
Treatment	✓✓✓	✓✓✓		✓✓✓	

✓:POR獲得済 ✓:POR獲得目標

DRAM向け装置ビジネスの現状と見通し

AI需要を背景に、世代交代投資とキャパシティアップ投資が並行で実施される見通し。
装置+アップグレード改造により大きな成長を見込む。

DRAM向け装置売上



	2021	2023	2026	2027
Advanced 2D DRAM	微細化・複雑化→三次元化			
	D1a	D1b	D1c	D1d
bWL	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
└ Treatment	—	—	—	✓✓✓✓✓
Top Electrode	✓	✓	✓✓✓	✓✓✓
Bottom Electrode	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓✓
└ Treatment	✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Cylinder Support	—	—	—	✓

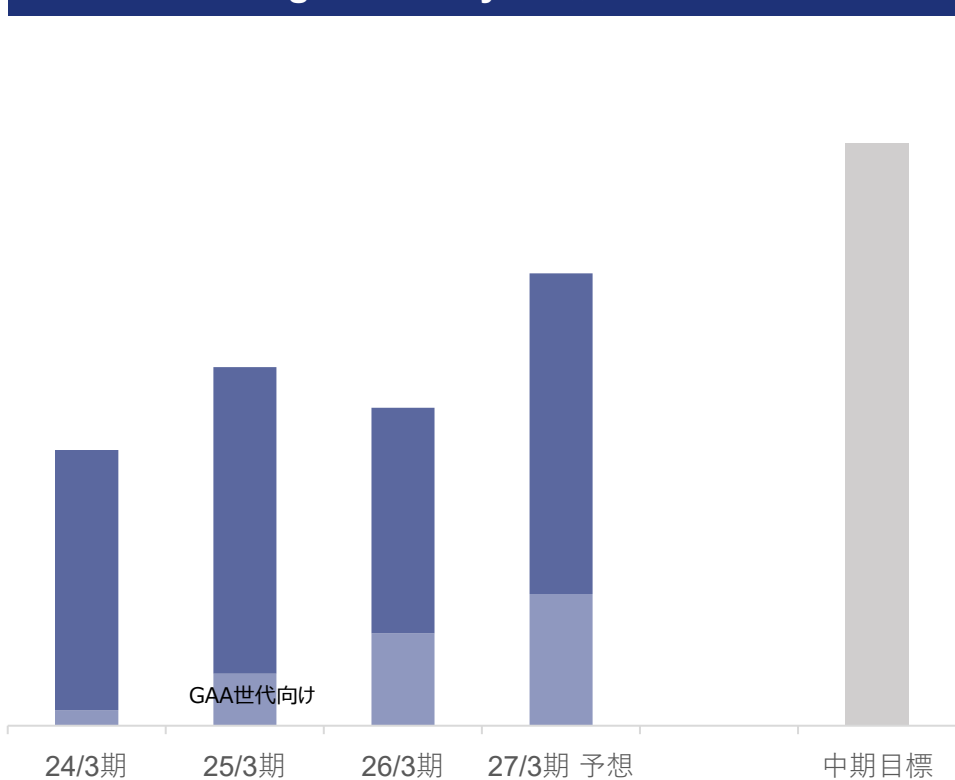
✓:POR獲得済 ✓:POR獲得目標

Logic/Foundry向け装置ビジネスの現状と見通し

GAA特有の高難易度成膜POR獲得により新規需要を見込む。

アドバンスドパッケージ向け装置販売、成熟ノード向け装置販売の回復も期待。

Logic/Foundry向け装置売上



	2024	2025	2026	2027	2028
Logic	複雑化→三次元化				
	FinFET	GAA(2nm)	GAA(1.4nm)		
Gate Spacer	✓✓✓	✓✓✓		✓✓✓	
Inner Spacer	—	✓✓✓		✓✓✓✓✓	
Hard Mask*1	—	✓		✓✓✓	
Gapfill	—	✓		✓✓✓✓✓	
Treatment	—		—	✓	

*1 ナノシート保護用のハードマスク

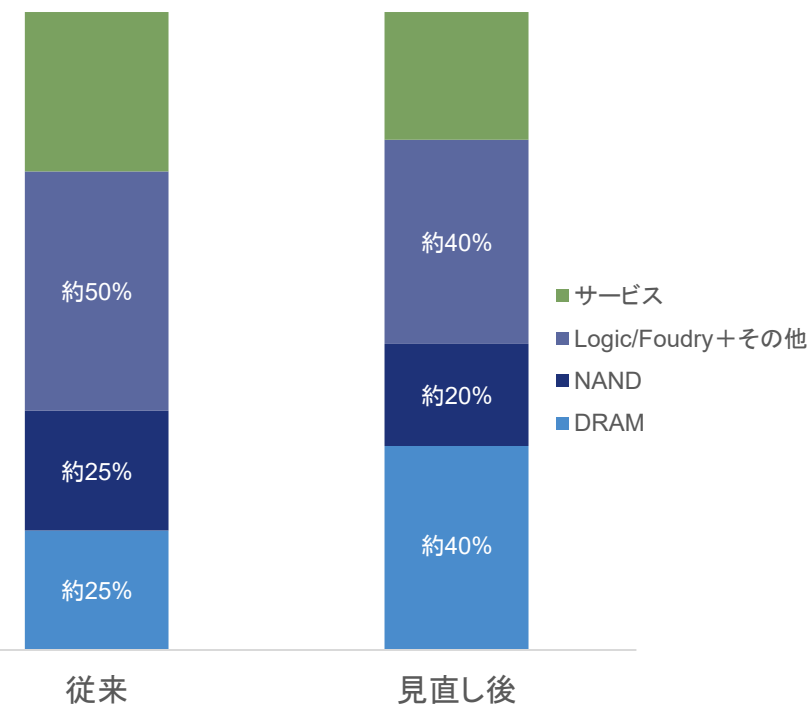
✓: POR獲得済 ✓: POR獲得目標

中期経営計画(5月13日更新)

2024年の中期経営計画策定時から市場環境が大きく変化したことを受け、中期目標の達成時期を2029年3月期までに達成とし、アプリケーション別売上構成比と合わせて見直し。現状に即した成長戦略を推進。

達成時期	従来の中期目標*1 WFE市場規模 1,200億ドル以上	見直し後の中期目標 2029年3月期まで
売上収益	3,300億円以上	3,300億円以上
装置ビジネス 売上比率	75%程度	80%程度
サービスビジネス 売上比率	25%程度	20%程度
調整後営業利益率*2	30%以上	30%以上
研究開発費 (対売上収益比率)	6%以上	6%以上
ROE(参考)	25%以上	25%以上
ROIC(参考)	23%以上	23%以上

アプリケーション別売上構成比*3



*1: 中長期事業目標に関して足許の環境や進捗状況を踏まえた現時点における中計の着地見込みを中期事業目標と記載

*2: 調整後営業利益＝営業利益－その他の収益＋その他の費用＋企業結合により識別した無形資産等の償却＋スタンダードローン関連費用＋特殊要因を除く株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)

調整後営業利益率＝調整後営業利益÷売上収益

*3: 装置売上の比率

砺波事業所に隣接する土地の取得を決定

2031年以降のさらなる市場拡大を見越して、富山県砺波市が所有する砺波事業所に隣接する土地の取得を決定。生産や研究開発など当社グループにおけるさまざまな取り組みに寄与する見込み。



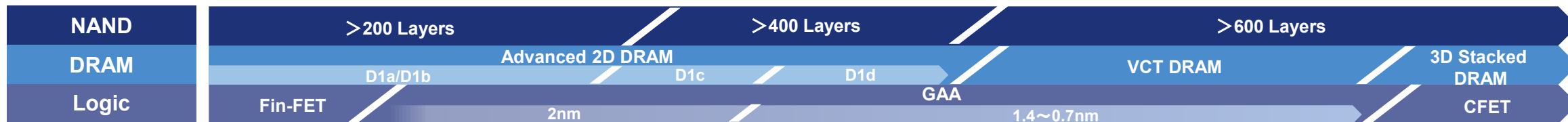
所在地	高岡砺波スマートIC柳瀬 第2団地
敷地面積	約43,000㎡
取得価額	約10億円

まとめ

半導体デバイスの進化に伴う多層化、微細化、複雑化、三次元化により高付加価値製品の適用機会が拡大、技術的優位性を生かして市場成長を上回る事業拡大をめざす。

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
------	------	------	------	------	------	------	------

デバイス
ロードマップ



事業環境

短期

- NAND
 - 世界各国向けNANDは世代交代投資が継続(200~300層)。
 - 中国地場向けNANDは2026年前半は端境期も後半から投資再開。
- DRAM、Logic/Foundry
 - 世代交代、生産規模拡大に向けた投資が継続。
 - 中国地場向けLogic/Foundry新興メーカーは、一定規模の投資が継続。

中期

- NAND
 - 世界各国向け及び中国地場向けは世代交代投資が中心となる見通し。
- DRAM
 - D1d~VCT DRAM、への世代交代、生産規模拡大に向けた投資が活発化。
- Logic/Foundry
 - GAA 1.4nmへの世代交代、生産規模拡大に向けた投資が活発化。

長期

- NAND
 - 世界各国向けは600層以上の世代交代に向けた投資が活発化。
- DRAM
 - VCT DRAM、3D Stacked DRAMへの世代交代、生産規模拡大に向けた投資が活発化。
- Logic/Foundry
 - CFETへの世代交代、生産規模拡大に向けた投資が活発化。

当社
カタリスト

短期~中期

- AI需要による更なる高性能DRAM・Logic/Foundryの投資拡大を背景に、高付加価値製品の適用機会が拡大。
- NANDにおいて、生産規模拡大投資は無くとも世代交代投資の継続により、高付加価値製品の需要増加が期待。
- 競争優位性のある成膜技術をアドバンスドパッケージ分野での活用拡大へ向けた評価・POR獲得の進展。

長期

- CFET、VCT DRAM、3D Stacked DRAM、600層以上 NANDへの世代交代に伴うさらなる需要拡大。
- アドバンスドパッケージ向けのさらなる規模拡大。



Appendix

事業運営体制の刷新

当社グループの持続的な成長を図るため、4月1日付で事業運営体制を刷新。

 **塚田 和徳**
代表取締役
社長執行役員
業務執行の統括

 柳川 秀宏 取締役 専務執行役員 価値創造プロセス革新、 セールス・アカウント統括	 山田 正行 常務執行役員 生産、設備・環境、 事業所運営統括	 河上 好隆 常務執行役員 経理・財務	 金山 健司 常務執行役員 技術統括、 先行技術開発、知財	 山峯 直利 常務執行役員 調達、品質保証、 IT・情報セキュリティ	 宮本 正巳 常務執行役員 装置ビジネス、 プロセス技術開発
 小竹 繁 執行役員 サービスビジネス、 量産設計	 川上 晴彦 執行役員 人事総務	 本間 靖之 執行役員 DX・BX、業務改革	 島田 真一 執行役員 システム技術開発	 能勢 雄章 執行役員 経営企画、広報・IR、 サステナビリティ、法務、倫理・ コンプライアンス、輸出管理	

経営戦略本部 能勢 雄章	法務本部 諸石 建二	知的財産本部 羽田 幸人	経理本部 小山 肇	人事総務本部 川上 晴彦	IT戦略本部 宮内 幸太郎	先行技術 開発本部 高浦 則克	サービスビジ ネス本部 矢野 雅彦	装置ビジ ネス本部 鎌倉 司	セールスオ ペレーション & アカウ ント マネー ジメン ト本部 Tim Trudgeon	プロセス 開発本部 南 政克	システム 開発本部 島田 真一	量産設計 本部 前田 喜世彦	ものづくり本部 野上 克明	設備環境 本部 若林 勲	調達本部 原 弘明
-----------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------	-----------------------	-------------------------	----------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------

日本 株式会社国際電気 セミコンダクターサービス	韓国 Kokusai Electric Korea Co., Ltd.	台湾 Kokusai Electric Asia Pacific Co., Ltd.	USA Kokusai Semiconductor Equipment Corporation	欧州 Kokusai Semiconductor Europe GmbH	中国 KE Semiconductor Equipment (Shanghai) Co., Ltd.	シンガポール Kokusai Semiconductor Singapore Pte. Ltd.
--------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

2026年3月期第4四半期の主な活動報告

経営・事業活動

- Intel Corporationより「2026 Intel EPIC Supplier Award」を受賞。(26/3)
- 「SEMICON® CHINA 2026」に出展。(26/3)
- 第73回 応用物理学会 春季学術講演会に協賛。(26/3)
- 「SEMICON® KOREA 2026」に出展。(26/2)
- 新本社での業務を開始。(26/1)



Intelより「2026 Intel EPIC Supplier Award」を受賞

ESGの取り組み

- 健康経営優良法人2026(大規模法人部門)に認定。(26/3)
- 令和7年度エコシップ・モーダルシフト事業優良事業者に認定。(26/3)
- TABLE FOR TWOから「2026年シルバーパートナー」として認定。(26/3)
- 富山マラソン2026にゴールドパートナーとしての協賛を決定。(26/3)
- プロサッカークラブ「カターレ富山」とオフィシャルパートナー契約を締結。(26/2)



健康経営優良法人2026(大規模法人部門)に認定

損益計算書及び研究開発費、設備投資額、減価償却費

(百万円)	25/3期					26/3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
売上収益	65,224	49,324	60,117	64,268	238,933	51,789	65,416	55,852	62,021	235,079
売上総利益	29,354	22,012	24,865	25,512	101,743	22,220	27,277	22,883	24,430	96,810
売上総利益率	45.0%	44.6%	41.4%	39.7%	42.6%	42.9%	41.7%	41.0%	39.4%	41.2%
調整後営業利益	19,382	11,299	13,876	13,196	57,753	10,902	14,439	11,290	10,965	47,596
調整後営業利益率	29.7%	22.9%	23.1%	20.5%	24.2%	21.1%	22.1%	20.2%	17.7%	20.2%
調整後当期(四半期)利益	14,345	7,262	9,646	11,050	42,303	7,598	9,785	8,292	8,420	34,095
調整後当期(四半期)利益率	22.0%	14.7%	16.0%	17.2%	17.7%	14.7%	15.0%	14.8%	13.6%	14.5%
営業利益	17,878	9,562	12,274	11,606	51,320	9,717	12,993	9,809	9,317	41,836
営業利益率	27.4%	19.4%	20.4%	18.1%	21.5%	18.8%	19.9%	17.6%	15.0%	17.8%
税引前当期(四半期)利益	17,747	10,195	11,241	11,606	50,789	9,322	12,840	9,412	9,165	40,739
税引前当期(四半期)利益率	27.2%	20.7%	18.7%	18.1%	21.3%	18.0%	19.6%	16.9%	14.8%	17.3%
当期(四半期)利益	13,302	4,751	8,004	9,947	36,004	6,776	8,782	7,264	7,277	30,099
当期(四半期)利益率	20.4%	9.6%	13.3%	15.5%	15.1%	13.1%	13.4%	13.0%	11.7%	12.8%
研究開発費	3,348	3,920	3,755	4,581	15,604	3,851	4,821	4,159	5,427	18,258
設備投資額	11,215	3,015	2,494	3,624	20,348	2,302	5,208	4,015	5,337	16,862
減価償却費	2,914	3,027	3,328	3,357	12,625	3,417	3,498	3,629	3,732	14,277

調整後利益等の計算における調整項目

	25/3期					26/3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
(百万円)										
営業利益	17,878	9,562	12,274	11,606	51,320	9,717	12,993	9,809	9,317	41,836
－その他の収益	△92	△187	△28	△41	△348	△304	△83	△70	△51	△508
＋その他の費用	27	78	79	69	253	18	53	74	223	368
(調整額)										
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,479	1,477	1,475	1,476	5,907	1,476	1,476	1,477	1,476	5,905
＋スタンドアローン関連費用	12	298	3	4	317	-	-	-	-	-
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	78	71	73	82	304	△5	-	-	-	△5
調整額 計	1,569	1,846	1,551	1,562	6,528	1,471	1,476	1,477	1,476	5,900
調整後営業利益	19,382	11,299	13,876	13,196	57,753	10,902	14,439	11,290	10,965	47,596
当期(四半期)利益	13,302	4,751	8,004	9,947	36,004	6,776	8,782	7,264	7,277	30,099
－その他の収益	△92	△187	△28	△41	△348	△304	△83	△70	△51	△508
＋その他の費用	27	78	79	69	253	18	53	74	223	368
(調整額)										
＋企業結合により識別した無形資産等の償却	1,479	1,477	1,475	1,476	5,907	1,476	1,476	1,477	1,476	5,905
＋スタンドアローン関連費用	12	298	3	4	317	-	-	-	-	-
＋株式報酬費用(業績連動型株式報酬制度に係るものを除く)	78	71	73	82	304	△5	-	-	-	△5
－調整項目に対する税金調整額	△461	△531	△491	△487	△1,970	△363	△443	△453	△505	△1,764
＋一時的な税金費用の調整額	-	1,305	531	-	1,836	-	-	-	-	-
調整後当期(四半期)利益	14,345	7,262	9,646	11,050	42,303	7,598	9,785	8,292	8,420	34,095

貸借対照表及び主要財務指標

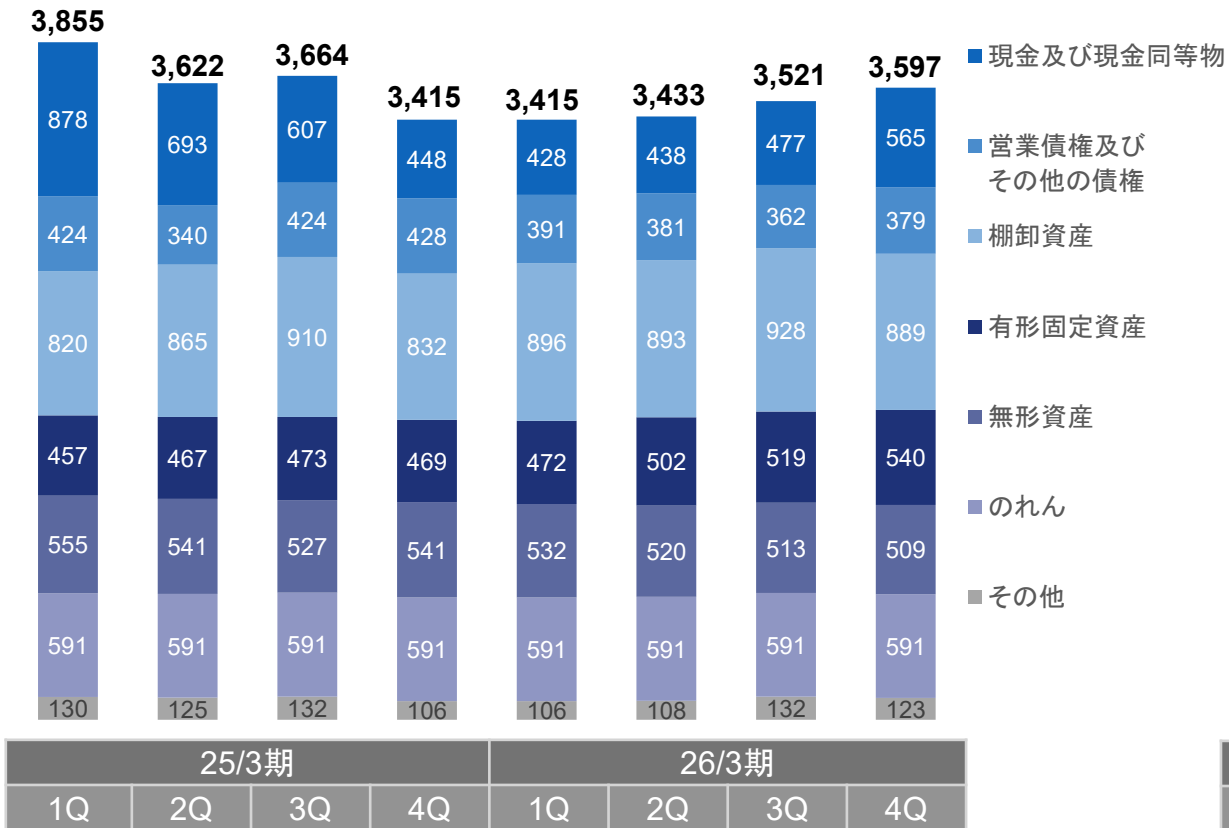
		25/3期					26/3期										
		(百万円)					(百万円)										
		4Q末	1Q末	2Q末	3Q末	4Q末	4Q末	1Q末	2Q末	3Q末	4Q末						
資産	流動資産	現金及び現金同等物	44,755	42,766	43,806	47,728	56,543	負債	流動負債	借入金＋リース負債	11,928	11,956	12,044	12,161	12,373		
		営業債権及びその他の債権	42,835	39,087	38,066	36,152	37,941			営業債務及びその他の債務	23,606	24,574	25,658	26,361	25,354		
		棚卸資産	83,200	89,626	89,326	92,758	88,890			契約負債	22,455	25,069	21,704	27,666	34,840		
		その他	2,062	2,038	2,065	2,905	2,465			その他	24,682	17,991	18,687	15,263	18,162		
		流動資産合計	172,852	173,517	173,263	179,543	185,839			流動負債合計	82,671	79,590	78,093	81,451	90,729		
		非流動資産	有形固定資産	46,904	47,220	50,214	51,916		53,975		非流動負債	借入金＋リース負債	48,256	48,339	42,365	43,681	37,492
			のれん	59,065	59,065	59,065	59,065		59,065			その他	14,417	14,663	14,553	14,131	12,167
			無形資産	54,139	53,182	52,013	51,321		50,900			非流動負債合計	62,673	63,002	56,918	57,812	49,659
			その他	8,552	8,524	8,765	10,262		9,879		負債合計	145,344	142,592	135,011	139,263	140,388	
			非流動資産合計	168,660	167,991	170,057	172,564		173,819		資本合計	196,168	198,916	208,309	212,844	219,270	
資産合計			341,512	341,508	343,320	352,107	359,658	負債及び資本合計	341,512	341,508	343,320	352,107	359,658				

	25/3期	26/3期			
	4Q末	1Q末	2Q末	3Q末	4Q末
自己資本比率	57.4%	58.2%	60.7%	60.4%	61.0%
D/Eレシオ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
ネット・キャッシュ(百万円)	△ 15,429	△ 17,529	△ 10,603	△ 8,114	6,678

四半期別貸借対照表

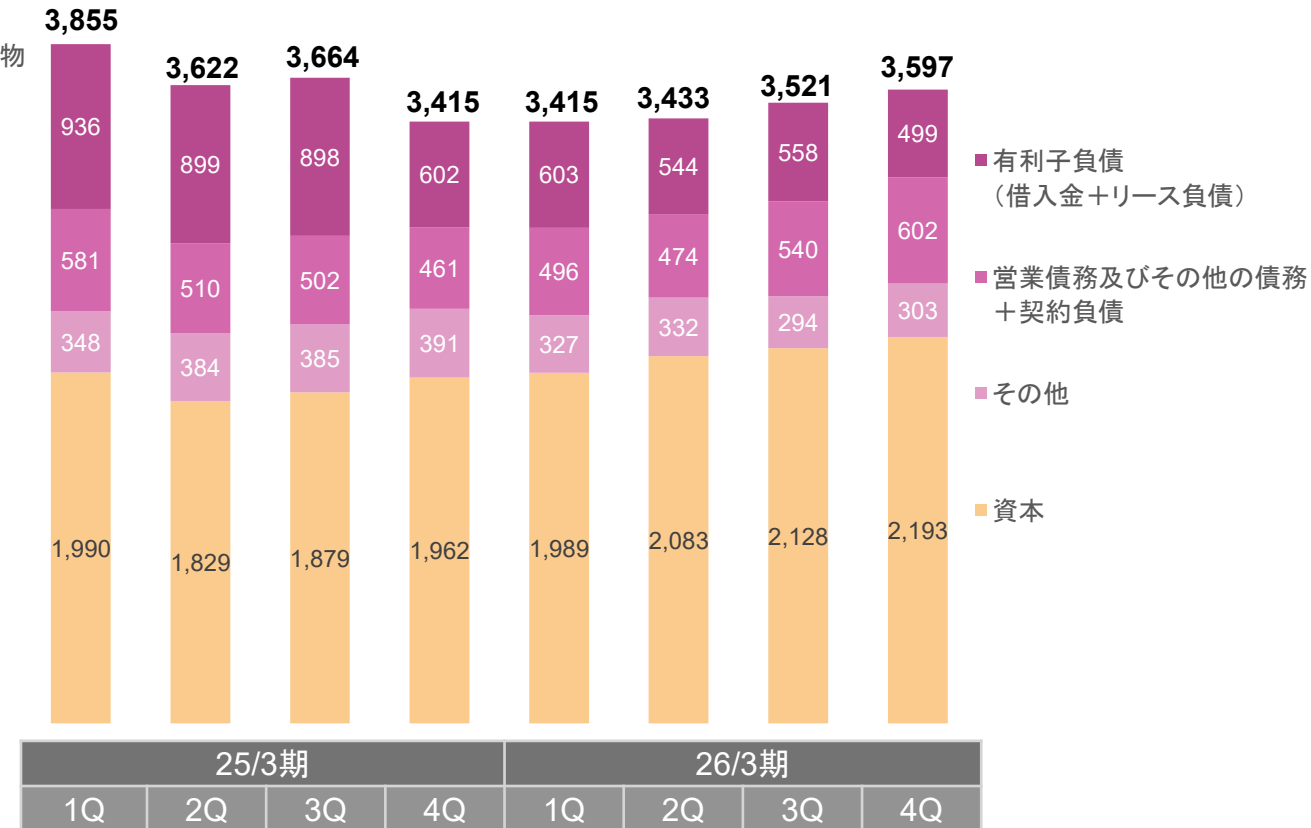
資産

(億円)



負債／資本

(億円)

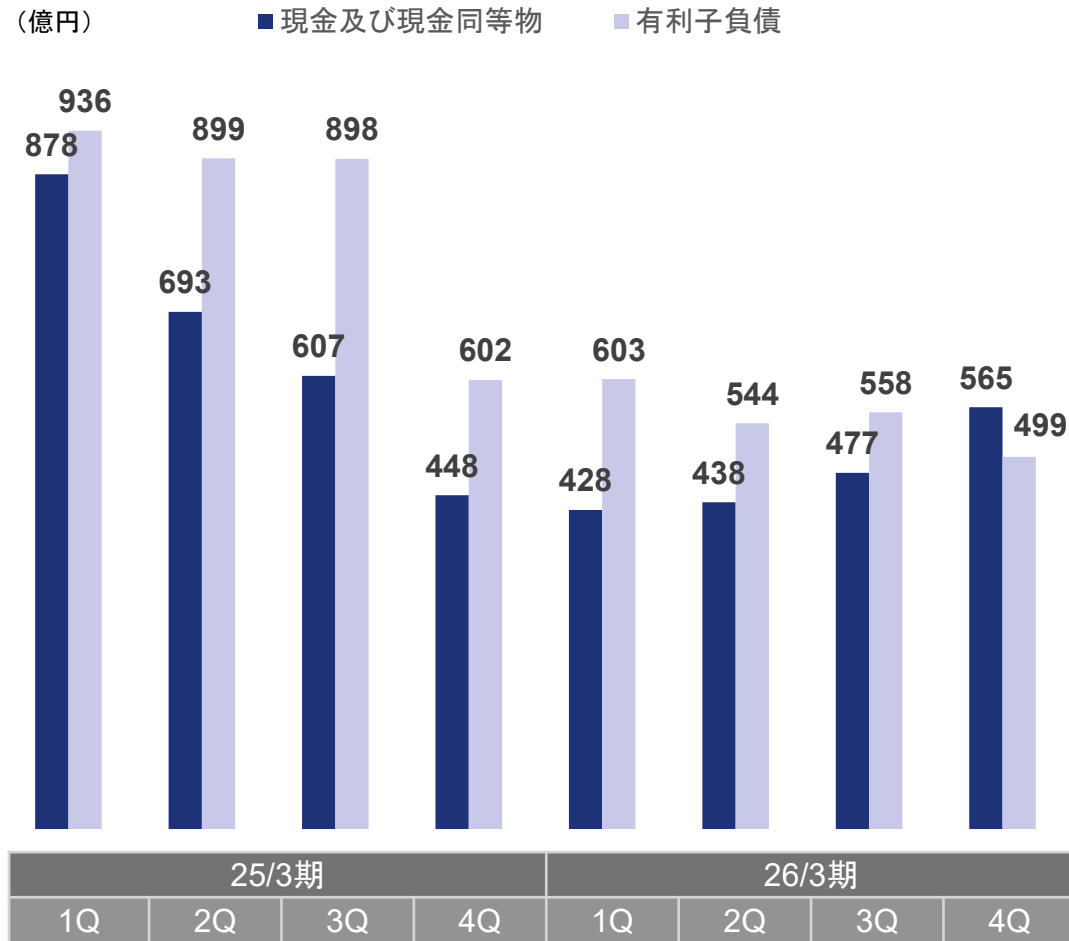


四半期別自己資本比率&現金及び現金同等物／有利子負債

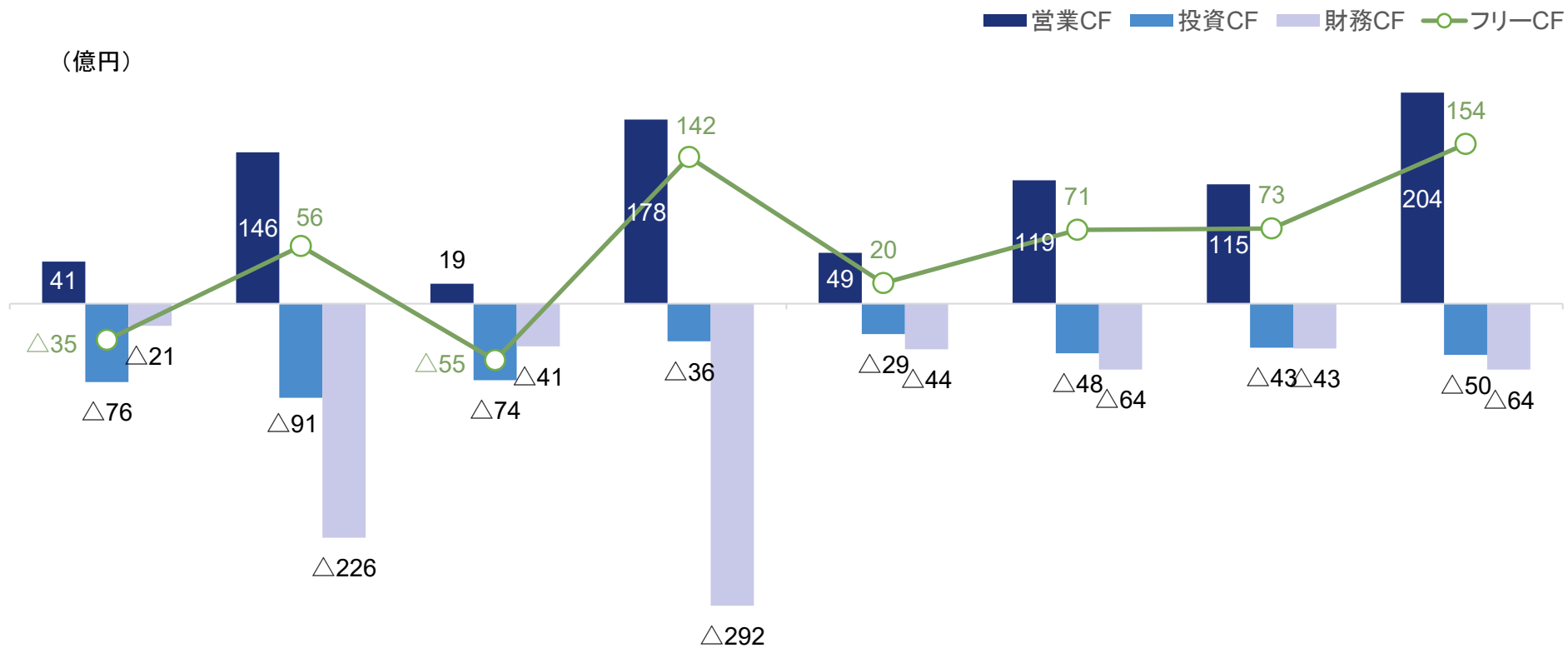
資産合計／資本合計／自己資本比率



現金及び現金同等物／有利子負債



四半期別キャッシュ・フロー



(億円)	25/3期				26/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
営業CF	+41	+146	+19	+178	+49	+119	+115	+204
投資CF	△76	△91	△74	△36	△29	△48	△43	△50
財務CF	△21	△226	△41	△292	△44	△64	△43	△64
フリーCF	△35	+56	△55	+142	+20	+71	+73	+154
現金及び現金同等物残高	878	693	607	448	428	438	477	565

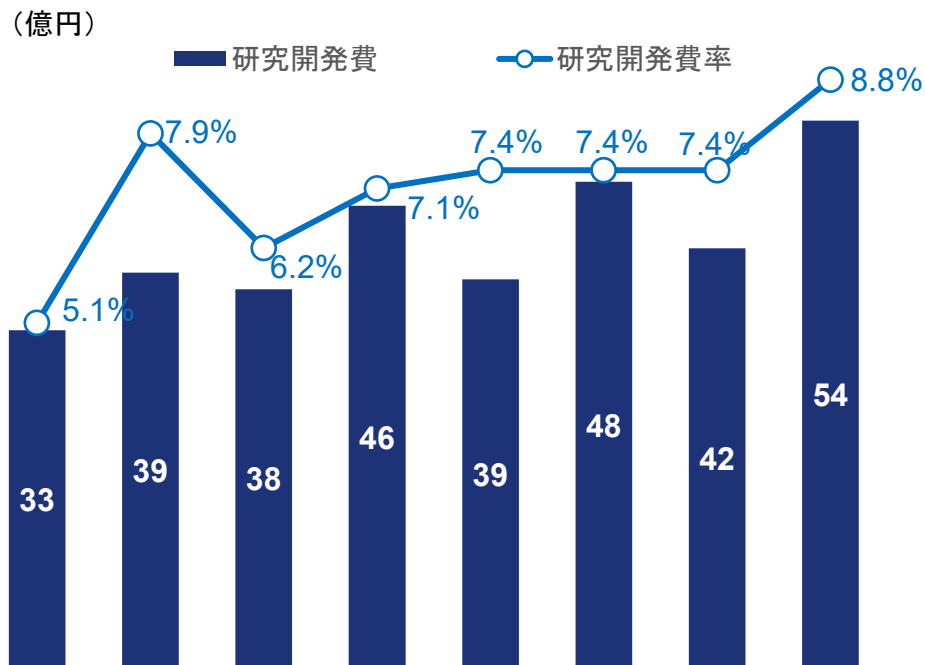
キャッシュ・フロー計算書

(百万円)

	25/3期					26/3期				
	1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,073	14,649	1,936	17,819	38,477	4,923	11,936	11,538	20,404	48,801
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,582	△ 9,090	△ 7,393	△ 3,641	△ 27,706	△ 2,942	△ 4,789	△ 4,263	△ 4,960	△ 16,954
フリー・キャッシュ・フロー	△ 3,509	5,559	△ 5,457	14,178	10,771	1,981	7,147	7,275	15,444	31,847
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,143	△ 22,628	△ 4,128	△ 29,207	△ 58,106	△ 4,423	△ 6,373	△ 4,339	△ 6,379	△ 21,514
現金及び現金同等物の期首残高	92,619	87,775	69,333	60,722	92,619	44,755	42,766	43,806	47,728	44,755
現金及び現金同等物の四半期末残高	87,775	69,333	60,722	44,755	44,755	42,766	43,806	47,728	56,543	56,543

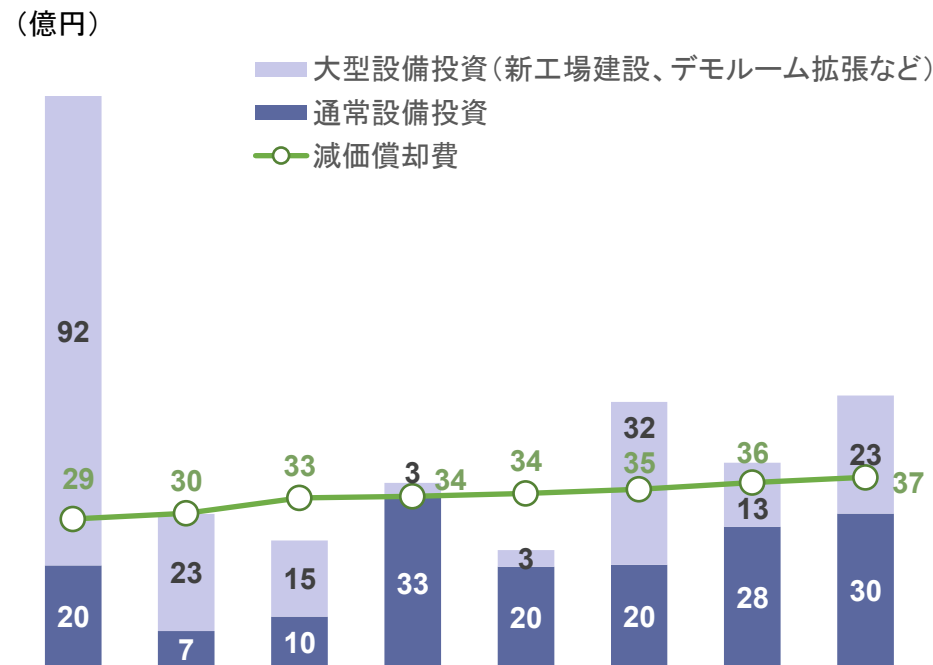
四半期別研究開発費／設備投資額／減価償却費

研究開発費



(億円)	25/3期				26/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
研究開発費	33	39	38	46	39	48	42	54
売上収益比	5.1%	7.9%	6.2%	7.1%	7.4%	7.4%	7.4%	8.8%

設備投資額／減価償却費



(億円)	25/3期				26/3期			
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
設備投資額計	112	30	25	36	23	52	40	53
売上収益比	17.2%	6.1%	4.1%	5.6%	4.4%	8.0%	7.2%	8.6%
減価償却費	29	30	33	34	34	35	36	37
売上収益比	4.5%	6.1%	5.5%	5.2%	6.6%	5.3%	6.5%	6.0%

2026年3月期第3四半期までの主な活動報告 経営・事業活動

経営・事業活動

- 「SEMICON® JAPAN 2025」に出展。(25/12)
- 環境性能に優れた高断熱ヒーターを新開発。(25/12)
- TSMCからExcellent Production Support Awardを受賞。(25/11)
- 「SEMICON® EUROPA 2025」に出展。(25/11)
- 「T-Messe2025富山県ものづくり総合見本市」に出展。(25/10)
- 韓国政府が主催する「第18回半導体の日」において「大統領表彰」を受賞。(25/10)
- 「SEMICON® WEST 2025」に出展。(25/10)
- ASMPTと半導体パッケージ技術に関する共同開発契約を締結。(25/9)
- ロームから2025年度「優秀サプライヤー賞」を受賞。(25/9)
- 「SEMICON® TAIWAN 2025」に出展。(25/9)
- 「SSDM2025」で当社従業員が口頭発表。(25/9)
- 横浜国立大学との共同研究により次世代3D半導体デバイスの省エネルギー化に貢献する新規膜とその接合プロセスを実証。(25/6)
- 「SEMICON® Southeast Asia 2025」に出展。(25/5)
- 「MEMS Engineer FORUM 2025」に出展。(25/4)



TSMCからExcellent Production Support Awardを受賞



「SEMICON® TAIWAN 2025」当社グループの展示ブース

2026年3月期第3四半期までの主な活動報告 ESGの取り組み

ESGの取り組み

- 富山事業所がRBA のVAP監査で最高評価のプラチナ・ステータスを取得。(25/12)
- SBTiよりSBT認定(Net-Zero)を取得。(25/12)
- CDP 2025においてAリスト企業に選定。(25/12)
- 富山県内で開催された「富山マラソン2025」にゴールドパートナーとして協賛。(25/11)
- 厚生労働大臣から「プラチナくるみん」「えるぼし」の認定を取得。(25/10)
- 富山市八尾町で開催された「おわら風の盆」に協賛。(25/9)
- CDP2024「サプライヤー・エンゲージメント評価」で最高評価を獲得。(25/7)
- 「FTSE Blossom Japan Sector Relative Index」の構成銘柄に選定。(25/6)
- TechInsightsの顧客満足度調査「Global Semiconductor Supplier Awards」で「Top 10 Customer Service」を28年連続で受賞。(25/5)
- 保育所施設で青空環境教室を実施。(25/5)
- 100%再生可能エネルギーの使用をめざす国際イニシアティブ「RE100」に参画。(25/4)
- 富山事業所で「とやま水の郷でんき」の使用量を全体の35%に引き上げ。(25/4)
- 富山県砺波市で開催される「2025となみチューリップフェア」に協賛。(25/4)
- 富山マラソン2025にゴールドパートナーとしての協賛を決定。(25/4)



CDP2024で
サプライヤー・エンゲージメント・リーダーに選定



富山マラソン2025に
ゴールドパートナーとして協賛

用語集

- バッチ処理装置：多数のウェーハを一括処理する装置
- 枚葉トリートメント装置：ウェーハを1枚単位で処理する枚葉方式により成膜後の膜質を改善する装置
- ALD: Atomic Layer Depositionの略
当社グループでは、複数のガスをサイクリックに供給する工程を伴い、原子層レベルで成膜する手法を「ALD」と呼んでいます。
- CVD: Chemical Vapor Depositionの略
- CFET: Complimentary Field Effect Transistorの略
- FinFET: Fin Field Effect Transistorの略
- GAA: Gate All Aroundの略
- HBM: High Bandwidth Memoryの略
- POR : Process of Recordの略で、顧客の半導体製造プロセスにおける製造装置認定を指す。
- TAM: Total Addressable Marketの略
- VCT: Vertical Channel Transistorの略
- WFE : Wafer Fab Equipmentの略

